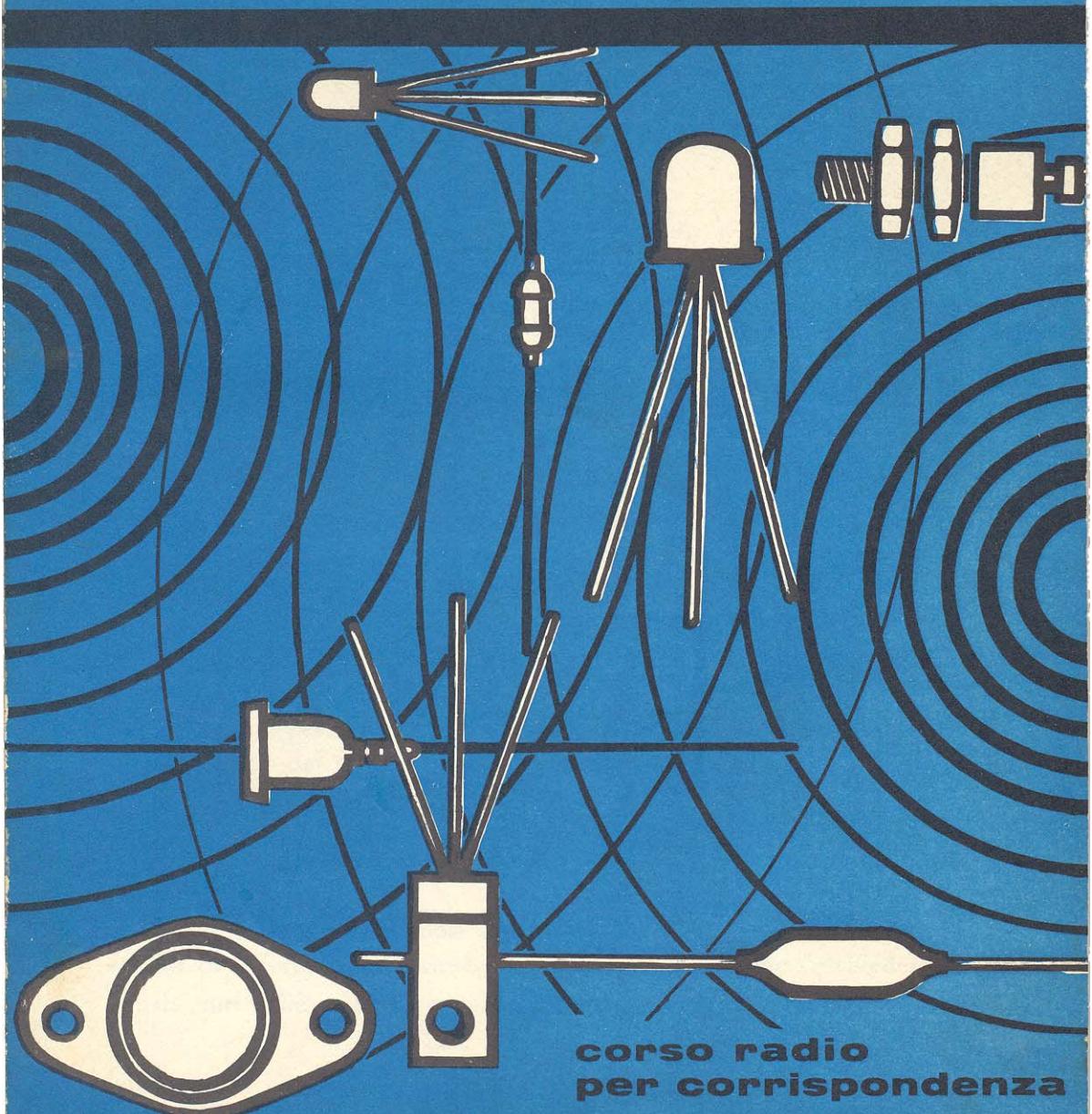


dati transistori



Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5 - Torino



corso radio
per corrispondenza

(41 RS)

P R E M E S S A

Il presente prontuario riassume i dati tecnici più importanti che caratterizzano il maggior numero possibile dei transistori di tipo europeo, usati particolarmente in campo radio e TV.

Ciò allo scopo di fornire al tecnico riparatore ed a chi si dedica alla realizzazione di apparecchiature sperimentali una guida utile e di facile consultazione per l'identificazione delle principali caratteristiche elettriche e meccaniche dei transistori di tipo più corrente.

I dati raccolti in questo prontuario hanno naturalmente scopo essenzialmente di orientamento.

Coloro che, dedicandosi alla progettazione di apparecchiature, necessitino di informazioni tecniche più dettagliate, potranno richiedere i manuali editi dalle case costruttrici dei semiconduttori.

1. - ELENCO E DEFINIZIONI DEI SIMBOLI DEL PRESENTE PRONTUARIO

f	: frequenza
f_β	: frequenza di taglio del guadagno di corrente con uscita in cortocircuito (montaggio ad emettitore comune)
f_T	: frequenza di transizione
G_p	: guadagno di potenza
G_{tr}	: guadagno di trasduzione di potenza
G_{UM}	: guadagno di potenza unilaterizzato
h_{FE}	: guadagno statico di corrente (emettitore comune)
I_C	: corrente di collettore
P	: potenza dissipata
R_{BE}	: resistenza esterna base-emettitore
R_{tha}	: resistenza termica fra la giunzione e l'ambiente (transistore in aria libera)
R_{thc}	: resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore
T_a	: temperatura ambiente
T_c	: temperatura del contenitore
T_j	: temperatura della giunzione
t_{off}	: tempo di commutazione in apertura
t_{on}	: tempo di commutazione in chiusura
V_{CBO}	: tensione collettore-base (emettitore aperto)
V_{CE}	: tensione collettore-emettitore
V_{CEO}	: tensione collettore-emettitore (base aperta)
V_{CER}	: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore chiusa su un dato resistore R_{BE})
V_{CES}	: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore in cortocircuito)
V_{CEX}	: tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore polarizzata in senso inverso)
y_{fe}	: ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; montaggio ad emettitore comune)
y_{fb}	: ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; montaggio a base comune)
β	: guadagno di corrente dinamico (uscita in cortocircuito; montaggio ad emettitore comune).

2. - ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

alim.	=	alimentazione
ampl.	=	amplificatore
commut.	=	commutazione
compl.	=	complementare
cont.	=	contenitore
conv.	=	convertitore
diss.	=	dissipatore
orizz.	=	orizzontale
oscill.	=	oscillatore
preampl.	=	preamplificatore
sincr.	=	sincronizzazione
vert.	=	verticale.

3. - COME CONSULTARE IL PRONTUARIO

Al fine di consentire una ricerca agevole e rapida, i transistori sono stati riportati seguendo un ordine alfabetico.

Per ciascun transistore sono riportati i dati più importanti, ripartiti sostanzialmente in cinque colonne; nella testata orizzontale in alto si trova, incominciando da sinistra:

- 1) la sigla del transistore;
- 2) la struttura, ossia se è PNP o NPN e, immediatamente sotto, il tipo di contenitore; le connessioni relative sono riportate nelle ultime pagine del Prontuario (Dati Transistori 2);
- 3) l'applicazione tipica per la quale è stato particolarmente studiato (per ragioni di spazio si sono adottate le numerose abbreviazioni sopra specificate);
- 4) i valori massimi assoluti;
- 5) i dati elettrici caratteristici.

Tutte le grandezze sono indicate con le rispettive unità di misura,

ossia:

V = volt	kHz = chilohertz
A = ampère	MHz = megahertz
mA = milliampère	mS = millisiemens
W = watt	ns = nanosecondi
°C = gradi centigradi	μs = microsecondi

E' bene fare subito una distinzione fra i valori massimi assoluti e le caratteristiche elettriche.

I *valori massimi assoluti* sono valori limite superati i quali il semiconduttore può danneggiarsi in modo permanente.

Questi limiti dipendono dalle caratteristiche proprie del semiconduttore e vengono quindi stabiliti dal costruttore.

Trattandosi di valori massimi assoluti, devono essere considerati come le estreme possibilità del dispositivo. Le condizioni normali di progetto devono rimanere molto al di sotto di questi valori, che non devono neanche essere raggiunti durante le peggiori condizioni di funzionamento che si possono presentare.

Le *caratteristiche elettriche*, al contrario, mettono in risalto i parametri più importanti del semiconduttore ed esprimono una proprietà tipica, in una specifica condizione di misura, per la quale il semiconduttore consente prestazioni ripetibili.

Dopo queste precisazioni, possiamo ora esaminare il significato e l'esatta interpretazione dei dati riportati.

4. - VALORI MASSIMI DI TENSIONE E DI CORRENTE

Sono riportati i valori delle tensioni inverse di rottura applicate alle giunzioni collettore-base e collettore-emettitore. Il valore massimo di tensione V_{CEO} corrisponde alla tensione inversa di rottura della giunzione collettore-base (con emettitore aperto).

La tensione di rottura della giunzione collettore-emettitore interessa invece due giunzioni: la giunzione collettore-base, polarizzata sempre in senso inverso, e la giunzione emettitore-base che al contrario può essere aperta, chiusa su un determinato resistore R_{BE} , chiusa in cortocircuito, oppure polarizzata in senso inverso con una determinata tensione.

A queste quattro condizioni corrispondono tensioni di rottura di valore progressivamente crescente, indicate rispettivamente con i simboli V_{CEO} ; V_{CER} ; V_{CES} ; V_{CEX} .

La corrente di collettore I_C indicata rappresenta il valore massimo, da non superare, per evitare di danneggiare il transistore.

AVVERTENZA: tutti i valori massimi di tensione e di corrente riportati sul presente prontuario sono *espressi solo numericamente*, ossia essi si intendono, ovviamente, *negativi* per i transistori PNP e *positivi* per i transistori NPN.

5. - VALORI MASSIMI DI POTENZA E DI TEMPERATURA

Ciascun transistore è caratterizzato da una temperatura di giunzione massima T_{jmax} , superata la quale esso si danneggia.

La temperatura di giunzione T_j di un transistore dipende da tre variabili:

- la temperatura ambiente T_a
- la dissipazione di collettore P
- la resistenza termica R_{tha}

secondo la relazione

$$T_j = T_a + R_{tha} \cdot P$$

Esaminiamo brevemente il significato di queste tre grandezze.

La temperatura ambiente T_a è la temperatura dell'ambiente in cui si trova il transistore, la quale può essere anche relativamente alta a causa del calore prodotto da resistori o transistori di potenza che si trovino nelle immediate vicinanze del transistore considerato.

La potenza P è quella dissipata sul collettore: per un amplificatore in classe A, è data da:

$$P = V_{CE} \cdot I_C$$

dove

V_{CE} è la tensione continua collettore-emettitore;

I_C è la corrente continua di collettore, nelle normali condizioni di funzionamento.

Come accade per qualsiasi resistore, l'energia corrispondente alla potenza P dissipata dal transistore viene trasformata, per effetto Joule, in energia termica. Ciò determina un aumento della temperatura di giunzione, che si porta ad un valore più alto di quello della temperatura T_a . Questo aumento è tanto maggiore quanto più elevata è la potenza dissipata.

La resistenza termica R_{tha} è un coefficiente termico, denominato "resistenza termica giunzione-ambiente", tipico di ciascun transistore, che indica di quanti gradi centigradi aumenta la temperatura della giunzione per ogni watt di potenza dissipato sul collettore.

In pratica si può dire che la resistenza termica R_{tha} definisce l'attitudine del transistore considerato a cedere all'ambiente esterno, attraverso il proprio contenitore, il calore prodotto nel suo interno a causa della potenza dissipata.

In corrispondenza della massima temperatura di giunzione T_{jmax} ammessa, si otterrà dunque la massima potenza P_{max} che il transistore può dissipare, secondo la relazione:

$$1) \quad P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_a}{R_{tha}}$$

Questa formula consente quindi di calcolare la massima potenza che un transistore, supposto in aria libera, può dissipare.

Tenendo presente quanto detto precedentemente a proposito della resistenza termica R_{tha} , è intuitivo che, aumentando la superficie del contenitore, ad esempio corredandolo di un dissipatore termico o di alette di raffreddamento, è possibile aumentare la massima potenza dissipabile. In questo caso la resistenza termica giunzione-ambiente R_{tha} può essere più convenientemente considerata la somma di due parti e cioè:

$$2) \quad R_{tha} = R_{thc} + R_{thd}$$

dove

R_{thc} è la resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore;

R_{thd} è la resistenza termica del dissipatore (o più precisamente fra il dissipatore e l'ambiente).

Dopo questa spiegazione preliminare, possiamo esaminare ora i dati riportati sul presente manuale.

Il valore di potenza P indicato è quello massimo che il transistore può dissipare in aria libera, cioè senza alette di raffreddamento; esso è normalmente riferito ad una temperatura $T_a = 25^\circ\text{C}$, salvo i casi in cui è specificato espressamente un valore di T_a diverso.

Si può osservare in ogni caso che è sempre possibile calcolare la potenza massima P_x , dissipabile in aria libera ad una temperatura ambiente di valore qualsiasi T_{ax} , applicando la seguente formula:

$$3) \quad P_x = P \cdot \frac{T_j - T_{ax}}{T_j - T_a}$$

dove

P è la potenza massima riferita alla temperatura ambiente T_a ;

T_j è la temperatura massima della giunzione;

T_{ax} è la temperatura ambiente in corrispondenza della quale si vuole calcolare la potenza P_x ;

T_a è la temperatura ambiente, letta sulla tabella, per la quale si ottiene la potenza nota P .

ESEMPIO

Per il transistore AC116 sono riportati i seguenti dati:

$$P = 145 \text{ mW}$$

$$T_j = 90^\circ\text{C}$$

Poiché non è indicato uno specifico valore di T_a , si intende che questa potenza è valida per una temperatura ambiente $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Supponiamo ora di voler conoscere la potenza massima P_x che il transistore AC116 è ancora in grado di dissipare ad una temperatura ambiente $T_{ax} = 45^\circ\text{C}$.

Applicando la formula 3) si trova:

$$P_x = P \cdot \frac{T_j - T_{ax}}{T_j - T_a} = 145 \cdot \frac{90 - 45}{90 - 25} = 145 \cdot \frac{45}{65} = \frac{6.525}{65} \cong 100 \text{ mW.}$$

La potenza massima che il transistore AC116 può dissipare a temperatura ambiente $T_{ax} = 45^\circ\text{C}$ risulta dunque di soli 100 mW.

In altri casi il valore massimo di potenza P indicato sui dati è riportato in funzione, oltre che della temperatura T_a , di una specifica aletta per il raffreddamento o per il fissaggio su un dissipatore di calore, le cui caratteristiche sono espressamente chiarite.

Alcuni tipi di alette, di tipo standard, sono state numerate e le loro dimensioni sono riportate al termine del Prontuario (Dati Transistori 2).

In molte situazioni pratiche, essendo nota la resistenza termica giunzione-contenitore R_{thc} e fissata la temperatura ambiente di funzionamento T_a , è opportuno conoscere qual è la resistenza termica del dissipatore di calore R_{thd} , necessario perché la temperatura di giunzione non superi il limite assoluto T_{jmax} .

In questo caso, si calcola dapprima la resistenza termica R_{tha} con la formula:

$$4) \quad R_{tha} = \frac{T_j - T_a}{P}$$

Nota dai dati la resistenza termica R_{thc} , tenendo presente la relazione 2) si potrà trovare poi la resistenza termica del dissipatore R_{thd} , data da:

$$R_{thd} = R_{tha} - R_{thc}.$$

ESEMPIO

Siano $T_j = 125^\circ\text{C}$ la temperatura massima della giunzione
 $T_a = 60^\circ\text{C}$ la temperatura massima ambiente
 $P = 1 \text{ W}$ la potenza massima da dissipare

Applicando la formula 4) si ottiene:

$$R_{tha} = \frac{T_j - T_a}{P} = \frac{125 - 60}{1} = 65 \text{ }^\circ\text{C/W.}$$

Se la resistenza termica giunzione-contenitore è $R_{thc} = 50 \text{ }^\circ\text{C/W}$, la resistenza termica del dissipatore R_{thd} dovrà essere:

$$R_{thd} = R_{tha} - R_{thc} = 65 - 50 = 15 \text{ }^\circ\text{C/W}$$

(nel caso particolare in cui il dissipatore dovesse essere elettricamente isolato dal contenitore del transistore, mediante opportuna rondella isolante, occorrerà tener conto anche della resistenza termica di contatto fra contenitore e dissipatore. In pratica, al valore di R_{thd} calcolato nel modo su-

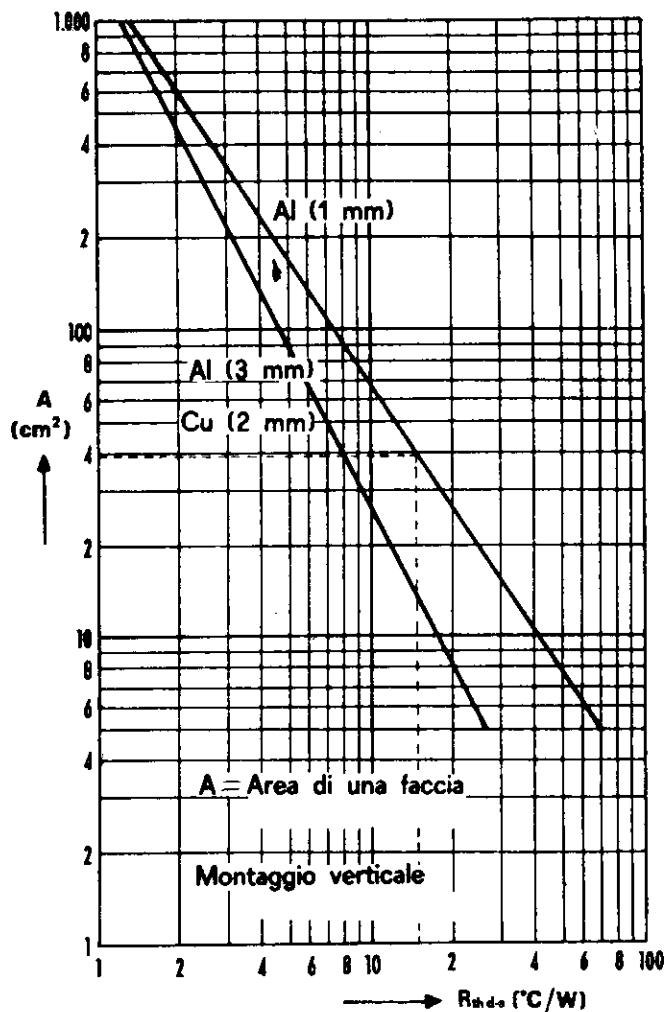


GRAFICO PER DETERMINARE LA SUPERFICIE DEL DISSIPATORE

Fig. 1

indicato potrà essere sottratto un valore di resistenza termica compreso fra 0,2 e 1 °C/W).

Nota la resistenza termica del dissipatore, la sua superficie può essere trovata mediante il grafico della fig. 1.

Per l'esempio considerato, in corrispondenza di $R_{thd} = 15 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$ si trova 39 cm^2 , che è la superficie del dissipatore di calore di alluminio (spesso 1 mm) necessario per il raffreddamento del transistore.

Il dissipatore deve avere preferibilmente forma quadrata. Nel caso di forma rettangolare, la lunghezza del lato più corto deve essere almeno due terzi di quella del lato maggiore.

Sovente, infine, nel caso di transistori di grande potenza, il valore limite di dissipazione indicato dal costruttore è quello massimo teorico, corrispondente all'impiego di un dissipatore infinitamente grande, di modo che la sua temperatura coincida praticamente con la temperatura ambiente.

Ne risulta che, in tali condizioni ipotetiche, la resistenza termica giunzione-ambiente è identica alla resistenza termica giunzione-contenitore ($R_{tha} = R_{thc}$).

Sui dati riportati è precisata, in questi casi, la temperatura massima ammessa del contenitore T_c , per la quale si ha, con dissipatore infinito, il valore di potenza massimo, dato da:

$$P_{max} = \frac{T_{jmax} - T_c}{R_{thc}}$$

Si fa presente che questo valore di potenza è puramente teorico, non essendo realizzabile in pratica un dissipatore infinitamente grande. La potenza che il transistore potrà dissipare in condizioni reali di funzionamento sarà sempre inferiore.

Questo modo di indicare la potenza, che sembra a prima vista non essere utile in pratica, serve invece per fare il calcolo senza tener conto del tipo di aletta che verrà usato.

Infatti, dare la P_{max} è come indicare la resistenza giunzione-contenitore essendo:

$$R_{thc} = \frac{T_j - T_c}{P_{max}}$$

Ottenuto questo valore, se si conosce la resistenza termica R_{thd} del dissipatore che si intende adottare, si può calcolare la resistenza termica giunzione-ambiente R_{tha} con la relazione:

$$R_{tha} = R_{thc} + R_{thd}$$

In base al valore di R_{tha} così calcolato si può risalire con la formula 1) al valore massimo reale di potenza dissipabile in funzione della temperatura ambiente T_a e del dissipatore prescelto. Diversamente, nota la potenza che il transistore deve dissipare e la temperatura ambiente, si calcola il valore della resistenza termica giunzione-ambiente R_{tha} con la relazione 4) e si procede poi come già visto in precedenza per determinare le dimensioni del dissipatore da usare.

6. - DATI ELETTRICI CARATTERISTICI

Le proprietà elettriche dei transistori possono essere rappresentate sotto forma di quantità numeriche, dette **PARAMETRI**, le quali indicano le relazioni esistenti tra le tensioni e le correnti all'ingresso ed all'uscita.

Sul prontuario sono stati riportati i parametri che di solito interessano di più, e che ora saranno brevemente descritti.

L'amplificazione statica di corrente h_{FE} (connessione ad emettitore comune) è il rapporto:

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$$

per specificati valori di corrente I_C e di tensione V_{CE} ; poiché la dipendenza

dalla tensione V_{CE} è piccola, talvolta il valore di h_{FE} è dato solo in funzione di I_C .

Il guadagno di corrente statico h_{FE} è indicativo dell'attitudine del transistore ad amplificare le frequenze molto basse, ed in tale campo la sua dipendenza dalla frequenza può ritenersi trascurabile.

L'amplificazione dinamica (cioè in corrente alternata) di un transistore nella connessione ad emettitore comune è definita invece dal parametro β , che indica il rapporto tra la variazione della corrente di collettore (per tensione di collettore costante) e la variazione corrispondente della corrente di base che l'ha provocata.

Il valore di β riportato sul prontuario è riferito alla frequenza convenzionale di 1 kHz.

Sovente un dato tipo di transistore viene suddiviso dal costruttore in diverse classi di guadagno (sia statico sia dinamico), contraddistinte con numeri, lettere o punti colorati; per ciascuna classe sono stati riportati, in questi casi, o il valore tipico o i valori minimo e massimo del guadagno (h_{FE} oppure β) corrispondente per specificati valori di I_C e V_{CE} .

Il guadagno di corrente dinamico β , sensibilmente costante per le frequenze basse, decresce invece rapidamente con le frequenze alte.

La frequenza di taglio f_β è la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico β è sceso al 70,7 % del valore a 1 kHz.

La frequenza di transizione f_T , detta anche *prodotto guadagno-ampiezza di banda*, è invece la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico β raggiunge l'unità.

La frequenza di taglio f_β e la frequenza di transizione f_T sono legate approssimativamente dalla seguente relazione:

$$f_T = \beta \cdot f_\beta$$

dove β è il guadagno a 1 kHz ad emettitore comune.

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

Per definire il comportamento di un transistore amplificatore in alta frequenza si riportano i valori del guadagno di potenza, che può essere espresso in diversi modi, a seconda delle condizioni di lavoro e delle condizioni circuitali in cui si trova il transistore.

Il guadagno di potenza G_p è definito come il rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza in ingresso: esso è, per dati parametri, funzione solo dell'impedenza del carico ed è indipendente da quella del generatore.

Il guadagno di potenza G_{tr} è il guadagno dato dal rapporto fra la potenza trasferita al carico e la potenza disponibile dal generatore di ingresso; esso quindi dipende sia dall'impedenza del generatore che dall'impedenza del carico.

Il guadagno massimo di potenza G_{UM} invece è il guadagno dato come rapporto fra la potenza in uscita e quella di ingresso, nelle condizioni di carico perfettamente adattato e circuito neutralizzato con rete passiva senza perdita.

L'ammettenza di trasferimento indicata y_{fe} (connessione ad emettitore comune) o y_{fb} (connessione a base comune), infine, definisce praticamente la transconduttanza del transistore, cioè il rapporto fra la variazione della corrente di uscita I_C e la corrispondente variazione della tensione di ingresso V_{BE} .

Questo parametro è funzione delle condizioni di lavoro e soprattutto della frequenza f di funzionamento.

Si fa presente che i valori di tensione V_{CE} e di I_C riportati sul prontuario, quando è riportato il parametro y_{fb} , sono da intendersi rispettivamente V_{CB} ed I_E .

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ C$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ C$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)	
AC116	PNP TO - 1K	Ampl. pilota BF	$V_{CEO} : 18 V$ $V_{CBO} : 30 V$ $I_C : 0,2 A$	$P : 145 mW$ $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 200^\circ C/W$	giallo verde hFE : 65 $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	$\beta : 55 - 95$ $\beta : 85 - 140$ 20 4	4 6 1 6	
AC117	PNP TO - 1K	Ampl. BF	$V_{CEO} : 18 V$ $V_{CBO} : 32 V$ $I_C : 1 A$	$P : 0,26 W$ $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 40^\circ C/W$	hFE : 120 $f_\beta : 10 \text{ kHz}$	50 10	6 2	
AC117P	PNP TO - 1K	Ampl. BF compl. AC175P		Dati tecnici come AC117 eccetto:	hFE : 60 - 400	150	2	
AC121	PNP TO - 1	Ampl. BF impiego generale	$V_{CEO} : 20 V$ $V_{CBO} : 20 V$ $I_C : 0,3 A$	$P : 0,15 W$ $T_a : 45^\circ C$ $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 50^\circ C/W$	IV hFE : 47 V hFE : 78 VI hFE : 114 VII hFE : 200 $f_\beta : 17 \text{ kHz}$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$	2 2 3 3 20 20	2 2 3 3 5 5	
AC122	PNP TO - 18L	Preampl. BF	$V_{CEO} : 18 V$ $V_{CBO} : 30 V$ $I_C : 0,2 A$	$P : 130 mW$ $T_j : 90^\circ C$	rosso giallo verde viola bianco	$\beta : 40 - 65$ $\beta : 55 - 95$ $\beta : 85 - 140$ $\beta : 130 - 200$ $\beta : 170 - 300$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	2 2 2 2 2 4	6 6 6 6 6 6
AC122/30	PNP TO - 18L			Impiego e dati tecnici come AC122 eccetto: $V_{CEO} : 32 V$ $V_{CBO} : 45 V$				
AC123	PNP TO - 1K	Ampl. pilota BF	$V_{CEO} : 32 V$ $V_{CBO} : 45 V$ $I_C : 0,2 A$	$P : 145 mW$ $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 200^\circ C/W$	giallo verde $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	hFE : 65 $\beta : 55 - 95$ $\beta : 85 - 140$ 4	20 4 6	
AC124	PNP TO - 1K	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 32 V$ $V_{CBO} : 45 V$ $I_C : 1 A$	$P : 0,26 W$ $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 40^\circ C/W$	hFE : 62,5 $f_\beta : 11 \text{ kHz}$	50 10	6 2	
AC124P	PNP TO - 1K			Impiego e dati tecnici come AC124 eccetto:	hFE : 60 - 170	150	2	
AC125	PNP TO - 1	Preampl. e pilota BF	$V_{CEO} : 12 V$ $V_{CBO} : 32 V$ $I_C : 0,1 A$	$P : 0,5 W$ $T_a : 45^\circ C$ aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 300^\circ C/W$	hFE : 100 $\beta : 125$ $f_T : 1,7 \text{ MHz}$ $f_\beta : 17 \text{ kHz}$	2 2 10 10	5 5 2 2	
AC126	PNP TO - 1	Preampl. e pilota BF	$V_{CEO} : 12 V$ $V_{CBO} : 32 V$ $I_C : 0,1 A$	$P : 0,5 W$ $T_a : 45^\circ C$ aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² $T_j : 90^\circ C$ $R_{thc} : 300^\circ C/W$	hFE : 140 $\beta : 180$ $f_T : 2,3 \text{ MHz}$ $f_\beta : 17 \text{ kHz}$	2 2 10 10	5 5 2 2	

DATI TRAISOLANTI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
	NPN	Pilota e finale BF compl. AC128 o AC132	$V_{CEO} : 12 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 0,5 \text{ A}$	$P : 0,34 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{tha} : 370^\circ\text{C/W}$ $R_{thc} : 110^\circ\text{C/W}$	$hFE : 100$ $f_T : 2,5 \text{ MHz}$ $f_\beta : 20 \text{ kHz}$	20 10 10	2 2 2
AC127		TO - 1					
	PNP	Finale BF compl. AC127	$V_{CEO} : 16 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 1 \text{ W}$ aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{tha} : 290^\circ\text{C/W}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$hFE : 100$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	50 10 10	2 2 2
AC128		TO - 1					
	PNP	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 6 \text{ V}$ $V_{CBO} : 9 \text{ V}$ $I_C : 10 \text{ mA}$	$P : 12 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 60^\circ\text{C}$	$\beta : 40 - 135$ $f_\beta : 25 \text{ kHz}$	0,25	2
C - 18							
	NPN	Stadi sincr. orizz. TV	$V_{CEO} : 10 \text{ V}$ $V_{CBO} : 20 \text{ V}$ $I_C : 0,1 \text{ A}$	$P : 145 \text{ mW}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : >25$ $f_T : >2 \text{ MHz}$	10 10	1 1
AC130		TO - 1					
	PNP	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 30 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 215 \text{ mW}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 100$ $f_\beta : 10 \text{ kHz}$	50 10	2 2
AC131		TO - 18L					
	PNP	Ampl. BF compl. AC186P	Dati tecnici come AC131 eccetto:		$hFE : 60 - 400$	150	2
AC131P		TO - 18L					
	PNP	Ampl. BF compl. AC186P	$V_{CEO} : 32 \text{ V}$ $V_{CBO} : 45 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 215 \text{ mW}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 100$ $f_\beta : 10 \text{ kHz}$	50 10	2 2
AC131/30		TO - 18L					
	PNP	Finale BF compl. AC127	$V_{CEO} : 12 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 0,2 \text{ A}$	$P : 0,5 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{tha} : 300^\circ\text{C/W}$ $R_{thc} : 50^\circ\text{C/W}$	$hFE : 135$ $f_T : 2 \text{ MHz}$ $f_\beta : 17 \text{ kHz}$	20 10 10	2 2 2
AC132		TO - 1					
	PNP	Ampl. pilota BF	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 20 \text{ V}$ $I_C : 35 \text{ mA}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $f_\beta : 650 \text{ kHz}$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	$\beta : 35$ $f_\beta : 650 \text{ kHz}$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	1 1	6 6
AC134		TO - 1					
	PNP	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 20 \text{ V}$ $I_C : 0,2 \text{ A}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $f_\beta : 65$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	$\beta : 65$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	50	1
AC135		TO - 1					
	PNP	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 25 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 0,2 \text{ A}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $f_\beta : 75$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	$\beta : 75$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	50	1
AC136		TO - 1					
	PNP	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 35 \text{ mA}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $f_\beta : 170$ $f_T : 0,8 \text{ MHz}$	$f_T : 0,8 \text{ MHz}$	5	1
AC137		TO - 1					

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
	PNP	Ampl. pilota BF Commutazione	$V_{CEO} : 20 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 1,2 \text{ A}$	$P : 0,72 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ aletta n. 1 con diss. alluminio 12,5 cm ² , spessore 1,5 mm $T_j : 90^\circ\text{C}$	$\beta : 30 - 250$ $f_T : 1,2 \text{ MHz}$	5	6
AC138		TO - 1					
	PNP	Ampl. finale BF Commutazione	$V_{CEO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	Dati tecnici come AC138 eccetto: $V_{CBO} : 32 \text{ V}$	$hFE : 40 - 110$ $f_T : 1,8 \text{ MHz}$	400	
AC139		TO - 1					
	NPN	Ampl. finale BF Commutazione	$V_{CBO} : 32 \text{ V}$	Dati tecnici come AC138 eccetto: $V_{CEO} : 32 \text{ V}$	$hFE : 40 - 110$ $f_T : 2,4 \text{ MHz}$	400	
AC141		TO - 1					
	NPN	Impiego e dati tecnici come AC138.					
AC141B		TO - 1					
	NPN	Ampl. finale BF	$V_{CBO} : 32 \text{ V}$	$P : 0,86 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ con diss. alluminio 12,5 cm ² , spessore 1,5 mm $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 40 - 110$ $f_T : 2,4 \text{ MHz}$	400	
AC141K		TO - 1K					
	PNP	Ampl. finale BF	$V_{CBO} : 32 \text{ V}$	Impiego e dati tecnici come AC138 eccetto: $V_{CEO} : 32 \text{ V}$	$f_T : 1,2 \text{ MHz}$		
AC142		TO - 1					
	PNP	Preamp. BF basso rumore	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 30 \text{ V}$ $I_C : 50 \text{ mA}$	$P : 0,1 \text{ W}$ $T_j : 75^\circ\text{C}$ $\beta : 55 - 95$ $\beta : 85 - 140$ $\beta : 130 - 200$ $\beta : 180 - 300$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	2 2 2 2 2 4 6	6 6 6 6 6 6 6	
AC150		TO - 18L					
	PNP	Ampl. BF uso generale	$V_{CEO} : 24 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 0,2 \text{ A}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 50^\circ\text{C/W}$	$IV \beta : 30 - 60$ $V \beta : 50 - 100$ $VI \beta : 75 - 150$ $VII \beta : 125 - 250$ $f_\beta : 47$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$	2 2 2 3 2 0,5 1	1 1 1 1 0,5 1 5
AC151		TO - 1					
	PNP	Ampl. BF uso generale	$V_{CEO} : 32 \text{ V}$	Dati tecnici come AC151 ma suddivisi solo nelle tre classi di guadagno IV, V, VI.	$IV hFE : 30 - 60$ $V hFE : 50 - 100$ $VI hFE : 75 - 150$ $VII hFE : 125 - 250$ $f_\beta : 47$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$	2 2 3 5 5 5 5	1 1 1 1 0,5 1 5
AC151r		TO - 1					
	PNP	Ampl. BF compl. AC127	$V_{CEO} : 24 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 0,5 \text{ A}$	$P : 0,15 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 50^\circ\text{C/W}$	$IV hFE : 30 - 60$ $V hFE : 50 - 100$ $VI hFE : 75 - 150$ $VII hFE : 125 - 250$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$	2 2 3 5 5 5	1 1 1 1 0,5 1
AC152		TO - 1					
	PNP	Ampl. BF compl. AC176	$V_{CEO} : 32 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 1 \text{ W}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$IV hFE : 66$ $V hFE : 97$ $VI hFE : 167$ $VII hFE : 187$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$	50 50 50 50 10 10	50 50 50 50 2 2
AC153		TO - 1					

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	a	I_C (mA)	V_{CE} (V)
AC153K	PNP compl. AC176K	Ampl. BF compl. AC176K	$V_{CEO} : 32\text{ V}$ $(R_{BE} \leq 500\text{ }\Omega)$	P : 1 W $T_c : 45^\circ\text{C}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $I_C : 1\text{ A}$ $R_{thc} : 45^\circ\text{C/W}$	V $hFE : 66$ VI $hFE : 97$ VII $hFE : 167$ $f_\beta : 15\text{ kHz}$ $f_T : 1,5\text{ MHz}$	50 50 50 10 2 10 2	
AC160	PNP basso rumore	Preampi. BF basso rumore	$V_{CEO} : 10\text{ V}$ $V_{CBO} : 15\text{ V}$ $I_C : 10\text{ mA}$	P : 50 mW $T_j : 75^\circ\text{C}$	rosso $\beta : 35 - 65$ giallo $\beta : 65 - 100$ verde $\beta : 80 - 150$ viola $\beta : 120 - 250$ $f_T : 2\text{ MHz}$	0,3 4,5 0,3 4,5 0,3 4,5 0,3 4,5 0,3 4,5	
AC162	PNP TO-1	Ampl. BF TO-1	$V_{CEO} : 24\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	P : 0,15 W $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 50^\circ\text{C/W}$	$hFE : 93$ $\beta : 80 - 170$ $f_\beta : 17\text{ kHz}$ $f_T : 1,7\text{ MHz}$	2 5 2 5 10 2 10 2	
AC163	PNP TO-1	Ampl. BF TO-1	$V_{CEO} : 24\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	P : 0,15 W $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 50^\circ\text{C/W}$	$hFE : 125$ $\beta : 130 - 300$ $f_\beta : 17\text{ kHz}$ $f_T : 2,3\text{ MHz}$	2 5 2 5 10 2 10 2	
AC170	PNP TO-18L	Preampi. e pilota BF TO-18L	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	P : 90 mW $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 125$ $\beta : 80 - 170$ $f_\beta : 17\text{ kHz}$ $f_T : 1,7\text{ MHz}$	2 5 2 6 10 2 10 2	
AC171	PNP TO-18L	Preampi. e pilota BF TO-18L	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	P : 80 mW $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 180$ $\beta : 130 - 300$ $f_\beta : 17\text{ kHz}$ $f_T : 2,3\text{ MHz}$	2 5 2 6 10 2 10 2	
AC172	NPN TO-1	Preampi. BF basso rumore TO-1	$V_{CEO} : 32\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 10\text{ mA}$	P : 0,2 W $T_j : 90^\circ\text{C}$	$\beta : 45 - 110$ $f_T : 2,5\text{ MHz}$	1 5 10 2	
AC175	NPN TO-1K	Ampl. finale BF TO-1K	$V_{CEO} : 18\text{ V}$ $V_{CBO} : 25\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	P : 0,26 W $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$hFE : 165$ $f_\beta : 20\text{ kHz}$	50 6 10 2	
AC175P	NPN TO-1K	Ampl. BF compl. AC117P	Dati tecnici come AC175 eccetto:		$hFE : 100 - 400$	150 2	
AC176	NPN TO-1	Ampl. BF compl. AC153	$V_{CEO} : 18\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	P : 1 W $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$hFE : 35$ $f_\beta : 15\text{ kHz}$ $f_T : 3\text{ MHz}$	50 2 10 2 10 2	
AC178K	NPN TO-1K	Ampl. BF compl. AC153K	$V_{CEO} : 18\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	P : 1 W $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 45^\circ\text{C/W}$	$hFE : 35$ $f_T : 3\text{ MHz}$	50 2 10 2	
AC178	PNP TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC179	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $V_{CBO} : 20\text{ V}$ $I_C : 0,7\text{ A}$	P : 0,18 W $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$hFE : 185$ $f_\beta : 10\text{ kHz}$	50 2 10 2	

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	a	I_C (mA)	V_{CE} (V)
AC178P	PNP TO-1K		Impiego e dati tecnici come AC178 eccetto:	$hFE : 100 - 400$	150	2	
AC179	NPN TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC178	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $V_{CBO} : 20\text{ V}$ $I_C : 0,7\text{ A}$	P : 0,18 W $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 40^\circ\text{C/W}$	$hFE : 185$ $f_\beta : 20\text{ kHz}$	50 2 10 2	
AC179P	NPN TO-1K		Impiego e dati tecnici come AC179 eccetto:	$hFE : 100 - 400$	150	2	
AC180	PNP TO-1	Ampl. finale BF compl. AC181	$V_{CEO} : 16\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 1,5\text{ A}$	P : 0,3 W $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 30^\circ\text{C/W}$	$V : hFE : 50 - 100$ VI $hFE : 75 - 150$ VII $hFE : 125 - 250$ $f_T : 2,5\text{ MHz}$ $f_\beta : 20\text{ kHz}$	600 1 600 1 600 1 1 6 1 6	
AC180K	PNP TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC181K	Dati tecnici come AC180 eccetto: P : 0,44 W				
AC180D			Equivalente all'AC180, ma selezionato per l'impiego negli stadi pilota di BF		blu $hFE : 70$ viola $hFE : 90$ bianco $hFE : 125$ grigio $hFE : 195$	10 1 10 1 10 1 10 1	
AC181	NPN TO-1	Ampl. finale BF compl. AC180	$V_{CEO} : 16\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	P : 0,3 W $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 30^\circ\text{C/W}$	$V : hFE : 50 - 100$ VI $hFE : 75 - 150$ VII $hFE : 125 - 250$ $f_T : 4,5\text{ MHz}$ $f_\beta : 35\text{ kHz}$	600 1 600 1 600 1 1 6 1 6	
AC181K	NPN TO-1K	Ampl. finale BF compl. AC180K	Dati tecnici come AC181 eccetto: P : 0,44 W				
AC181d			Equivalente all'AC181, ma selezionato per l'impiego negli stadi pilota di BF		blu $hFE : 70$ viola $hFE : 90$ bianco $hFE : 125$ grigio $hFE : 195$	10 1 10 1 10 1 10 1	
AC183	NPN TO-1	Preampi. e pilota BF	$V_{CEO} : 16\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,15\text{ A}$	P : 0,25 W $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 100^\circ\text{C/W}$	$V : \beta : 75$ VI $\beta : 110$ VII $\beta : 170$ $f_T : 4,5\text{ MHz}$ $f_\beta : 35\text{ kHz}$	2 6 2 6 2 6 1 6 1 6	
AC184	PNP TO-1	Ampl. finale BF compl. AC185	$V_{CEO} : 16\text{ V}$ $V_{CBO} : 32\text{ V}$ $I_C : 0,5\text{ A}$	P : 0,27 W $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 60^\circ\text{C/W}$	$V : hFE : 50 - 100$ VI $hFE : 75 - 150$ VII $hFE : 125 - 250$ $f_T : 2,5\text{ MHz}$ $f_\beta : 20\text{ kHz}$	300 1 300 1 300 1 1 6 1 6	
AC184D			Equivalente all'AC184, ma selezionato per l'impiego negli stadi pilota di BF		blu $hFE : 70$ viola $hFE : 90$ bianco $hFE : 125$ grigio $hFE : 195$	10 1 10 1 10 1 10 1	

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a	Ic (mA)	Vce (V)
AC185	NPN compl. AC184	Ampl. finale BF	Vceo : 16 V Vcbo : 32 V Ic : 0,5 A	P : 0,27 W Tj : 100 °C Rthc : 60 °C/W	V hFE : 50 - 100 VI hFE : 75 - 150 VII hFE : 125 - 250 fT : 4,5 MHz fβ : 35 kHz	300 300 300	1 1 1
						1	6
			TO - 1			1	6
AC185D		Equivalente all'AC185, ma selezionato per l'impiego negli stadi pilota di BF		blu viola bianco grigio	hFE : 70 hFE : 90 hFE : 25 hFE : 195	10 10 10 10	1 1 1 1
AC186	NPN	Ampl. pilota e finale BF	Vceo : 18 V Vcbo : 30 V Ic : 0,7 A	P : 0,215 W Tj : 90 °C	hFE : 100 fβ : 20 kHz	50 10	2 2
			TO - 18L				
AC186P	NPN TO - 18L	Ampl. finale BF compl. AC131P	Dati tecnici come AC186 eccetto:		hFE : 100 - 400	150	2
AC187	NPN compl. AC188	Ampl. finale BF	Vceo : 15 V Vcbo : 25 V Ic : 1 A	P : 0,56 W Ta : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² Tj : 90 °C Rthc : 40 °C/W	hFE : 300 fT : 3 MHz fβ : 20 kHz	300 10 10	1 2 2
AC187K	NPN compl. AC188K	Ampl. finale BF	Vceo : 15 V Vcbo : 25 V Ic : 1 A	P : 0,64 W Ta : 45 °C aletta n. 1 e diss. 12,5 cm ² Tj : 90 °C Rthc : 45 °C/W	hFE : 91 - 455 fT : 5 MHz fβ : 20 kHz	50 10 10	2 2 2
AC188	PNP TO - 1	Ampl. finale BF compl. AC187	Dati tecnici come AC187 eccetto:		fT : 1,5 MHz fβ : 10 kHz	10	2
AC188K	PNP TO - 1K	Ampl. finale BF compl. AC187K	Dati tecnici come AC187K eccetto:		fT : 1,5 MHz fβ : 10 kHz	10	2
AC191	PNP TO - 1	Ampl. BF basso rumore Commutazione	Vcbo : 32 V Ic : 0,25 A	P : 0,43 W Tj : 90 °C	β : 30 - 500 fT : 5,5 MHz	1	6
AC192	PNP TO - 1	Pilota BF Commutazione	Vcbo : 32 V Ic : 0,25 A	P : 0,43 W Tj : 90 °C	β : 30 - 500 fT : 5,5 MHz	1	6
AC193	PNP TO - 1	Pilota BF Commutazione	Vcbo : 32 V Ic : 1 A	P : 0,72 W aletta n. 1 con diss. alluminio 12,5 cm ² , spessore 1,5 mm Tj : 90 °C	hFE : 90 - 400 fT : 3 MHz	400	
AC193K	PNP TO - 1K	Impiego e dati tecnici come AC193 eccetto: P : 0,86 W					
AD130	PNP di potenza Circuiti alim.	Ampl. finale BF	Vceo : 30 V Vcbo : 32 V Ic : 3 A	P : 30 W Tc : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 1,5 °C/W	III hFE : 49 IV hFE : 74 V hFE : 124 fβ : 10 kHz fT : 0,35 MHz	60 60 60 600 600	2 2 2 2 2
TO - 3							

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a	Ic (mA)	Vce (V)
AD131	PNP di potenza Circuiti alim.	Ampl. finale BF	Vceo : 45 V Vcbo : 64 V Ic : 3 A	P : 30 W Tc : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 1,5 °C/W	III hFE : 49 IV hFE : 74 V hFE : 124 fT : 0,35 MHz fβ : 10 kHz	50 60 50 500 500	2 2 2 2 2
AD132	PNP di potenza Circuiti alim.	Ampl. finale BF	Vceo : 60 V Vcbo : 80 V Ic : 3 A	P : 30 W Tc : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 1,5 °C/W	III hFE : 49 IV hFE : 74 V hFE : 124 fT : 0,35 MHz fβ : 10 kHz	50 50 50 500 500	2 2 2 2 2
AD133	PNP di potenza Circuiti alim.	Ampl. finale BF	Vceo : 32 V Vcbo : 50 V Ic : 15 A	P : 36 W Tc : 45 °C Tj : 100 °C Rthc : 1,5 °C/W	III hFE : 50 IV hFE : 75 V hFE : 125 fT : 0,3 MHz fβ : 8 kHz	500 500 500 500 500	6 6 6 6 6
AD136	PNP di potenza Circuiti alim.	Ampl. finale BF	Vceo : 22 V Vcbo : 40 V Ic : 10 A	P : 11 W Tc : 45 °C Tj : 100 °C Rthc : 5 °C/W	IV hFE : 75 V hFE : 125 VI hFE : 180 fT : 0,3 MHz fβ : 8 kHz	500 500 500 500 500	6 6 6 6 6
AD138	PNP	Ampl. finale BF	Vceo : 25 V Vcbo : 40 V Ic : 8 A	P : 30 W Tc : 45 °C Tj : 90 °C Rthc : 1,5 °C/W	hFE : 62,5 fβ : 5,5 kHz	500 500	1,5 6
AD138/50	PNP	TO - 3	Impiego e dati tecnici come AD138 eccetto: Vceo : 35 V Vcbo : 70 V		Impiego e dati tecnici come AD138 eccetto: Vceo : 35 V Vcbo : 70 V		
AD139	PNP	Ampl. finale BF	Vceo : 20 V Vcbo : 32 V Ic : 3,5 A	SOT - 9	P : 13 W Tc : 38 °C Tj : 90 °C Rthc : 4 °C/W	hFE : > 20 fT : 0,6 MHz fβ : 10 kHz	10 100 100 2
AD142	PNP	Ampl. finale BF Commutazione	Vceo : 50 V Vcbo : 80 V Ic : 10 A	TO - 3	P : 30 W Tc : 55 °C Tj : 100 °C Rthc : 1,5 °C/W	hFE : 50 - 175	1000 2
AD143	PNP	TO - 3	Impiego e dati tecnici come AD142 eccetto: Vceo : 30 V Vcbo : 60 V		Impiego e dati tecnici come AD143 eccetto: Vceo : 25 V Vcbo : 32 V		
AD148	PNP	Ampl. finale BF	Vceo : 26 V Vcbo : 32 V Ic : 3,5 A	SOT - 9	P : 13,5 W Tc : 45 °C Tj : 100 °C Rthc : 4 °C/W	hFE : 51 fT : 0,45 MHz fβ : 12 kHz	500 500 2

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
AD149	PNP TO - 3	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 30 \text{ V}$ $V_{CBO} : 50 \text{ V}$ $I_C : 3,5 \text{ A}$	$P : 27,5 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 2^\circ\text{C/W}$	$IV \ hFE : 50$ $V \ hFE : 82$ $f_T : 0,5 \text{ MHz}$ $f_\beta : 10 \text{ kHz}$	50	1
						500	2
AD150	PNP TO - 3	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 30 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 3,5 \text{ A}$	$P : 27,5 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 100^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 2^\circ\text{C/W}$	$IV \ hFE : 50$ $V \ hFE : 82$ $f_T : 0,45 \text{ MHz}$ $f_\beta : 12 \text{ kHz}$	50	1
						500	2
AD152	PNP SOT - 9	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 23 \text{ V}$ $V_{CBO} : 45 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 7,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 83$ $f_\beta : 11 \text{ MHz}$	50	6
						10	2
AD155	PNP SOT - 9	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 15 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 7,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 125$ $f_\beta : 11 \text{ kHz}$	50	6
						10	2
AD155P	PNP SOT - 9	Ampl. elettron. e circuito alim.	Impiego e dati tecnici come AD155 eccetto:		$hFE : 65 - 320$	500	1
			$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 40 \text{ V}$ $I_C : 8 \text{ A}$	$P : 9 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 83$ $f_T : 0,3 \text{ MHz}$ $f_\beta : 8 \text{ kHz}$	500	0,5
AD159	PNP TO - 8	Commutazione e circuito alim.	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 40 \text{ V}$ $I_C : 8 \text{ A}$	$P : 9 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 83$ $f_T : 0,3 \text{ MHz}$ $f_\beta : 8 \text{ kHz}$	500	6
						500	6
AD160	PNP TO - 8	Commutazione e circuito alim.	$V_{CEO} : 22 \text{ V}$ $V_{CBO} : 40 \text{ V}$ $I_C : 10 \text{ A}$	$P : 9 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 155$ $f_T : 0,3 \text{ MHz}$ $f_\beta : 8 \text{ kHz}$	500	0,5
						500	6
AD161	NPN SOT - 9	Ampl. finale BF compl. AD162	$V_{CEO} : 20 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 4 \text{ W}$ $T_c : 72^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 4,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 80 - 320$ $f_T : 3 \text{ MHz}$ $f_\beta : 35 \text{ kHz}$	500	1
						10	2
AD162	PNP SOT - 9	Ampl. finale BF compl. AD161	$V_{CEO} : 20 \text{ V}$ $V_{CBO} : 32 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6 \text{ W}$ $T_c : 63^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 4,5^\circ\text{C/W}$	$VI \ hFE : 67$ $VII \ hFE : 98$ $VIII \ hFE : 170$ $IX \ hFE : 235$ $f_T : 1,5 \text{ MHz}$ $f_\beta : 15 \text{ kHz}$	50	2
						300	2
AD163	PNP TO - 3	Ampl. finale BF e circuito alim.	$V_{CEO} : 80 \text{ V}$ $V_{CBO} : 100 \text{ V}$ $I_C : 3 \text{ A}$	$P : 30 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 1,5^\circ\text{C/W}$	$II \ hFE : 30$ $III \ hFE : 49$ $IV \ hFE : 74$ $f_T : 0,35 \text{ MHz}$ $f_\beta : 10 \text{ kHz}$	50	2
						500	2
AD164	PNP SOT - 9	Ampl. finale BF e circuito alim.	$V_{CEO} : 20 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 7,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 120$ $f_\beta : 11 \text{ kHz}$	50	6
						10	2

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)	f (MHz)
AD164P	PNP SOT - 9			Impiego e dati tecnici come AD164 eccetto:			$hFE : 80 - 145$	500 1
AD165	NPN SOT - 9	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 20 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6,3 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 8,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 180$ $f_\beta : 20 \text{ kHz}$	50	6	
						10	2	
AD165P	NPN SOT - 9		Impiego e dati tecnici come AD165 eccetto:				$hFE : 80 - 345$	500 1
AD169	PNP SOT - 9	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 26 \text{ V}$ $V_{CBO} : 45 \text{ V}$ $I_C : 1 \text{ A}$	$P : 6 \text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 7,5^\circ\text{C/W}$	$hFE : 83$ $f_\beta : 11 \text{ kHz}$	50	6	
						10	2	
AD169P	PNP SOT - 9		Impiego e dati tecnici come AD169 eccetto:				$hFE : 40 - 160$	500 1
AF102	PNP TO - 7	Ampl. oscill. VHF	$V_{CEO} : 25 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 10 \text{ mA}$	$P : 75 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 75^\circ\text{C}$	$\beta : >20$ $f_T : 180 \text{ MHz}$ $y_{fb} : 25 \text{ mS}$	1	12	
						1	12	200
AF105	PNP RO - 8	Ampl. RF-FI per OM-OC	$V_{CEO} : 12 \text{ V}$ ($R_{BE} : 30 \text{ k}\Omega$) $V_{CBO} : 25 \text{ V}$	$P : 30 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 75^\circ\text{C}$	$hFE : 50$ $\beta : 60$ $y_{fe} : 19 \text{ mS}$ $f_T : 22 \text{ MHz}$	1	12	
						0,5	6	
AF106	PNP TO - 72	Preamp. RF oscill. conv. VHF	$V_{CEO} : 18 \text{ V}$ $V_{CBO} : 25 \text{ V}$ $I_C : 10 \text{ mA}$	$P : 60 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 70$ $\beta : 65$ $y_{fe} : 36 \text{ mS}$ $f_T : 220 \text{ MHz}$	2	6	
						1	12	35
AF106A	PNP TO - 72		Impiego e dati tecnici come AF106 eccetto:				$hFE : 20$	1 12
AF109R	PNP TO - 72	Ampl. RF fina a 260 MHz	$V_{CEO} : 15 \text{ V}$ $V_{CBO} : 20 \text{ V}$ $I_C : 10 \text{ mA}$	$P : 60 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$hFE : 55$ $y_{fb} : 22 \text{ mS}$ $f_T : 260 \text{ MHz}$	2	6	
						1,5	12	200
AF114	PNP TO - 7		Impiego e dati tecnici come AF124 eccetto: $P : 50 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$					
AF115	PNP TO - 7		Impiego e dati tecnici come AF125 eccetto: $P : 50 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$					
AF116	PNP TO - 7		Impiego e dati tecnici come AF126 eccetto: $P : 50 \text{ mW}$ $T_a : 45^\circ\text{C}$					
AF117	PNP TO - 7		Impiego e dati tecnici come AF127					
AF118	PNP video TV TO - 7	Ampl. finale video TV	$V_{CEO} : 70 \text{ V}$ allett. n. 4 $V_{CBO} : 70 \text{ V}$ $I_C : 30 \text{ mA}$	$P : 0,4 \text{ W}$ $f_T : 175 \text{ MHz}$ $T_j : 75^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 250^\circ\text{C/W}$	$hFE : 180$ $y_{fe} : 130 \text{ mS}$ $f_T : 175 \text{ MHz}$	10	2	
						10	6	10,7

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ C$)			CARATTERISTICHE a ($T_a = 25^\circ C$)			I_C (mA)	V_{CE} (V)	f (MHz)		
AF121	PNP	Ampl. RF oscill. AM-FM fino a 100 MHz	$V_{CEO} : 25 V$	$P : 65 mW$		$hFE : 75$	3	10					
			$VCBO : 25 V$	$T_a : 45^\circ C$		$\gamma_{fe} : 80 \text{ mS}$	3	10	35				
AF124	PNP	Ampl. RF-FM fino a 100 MHz	$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 75^\circ C$		$G_{tr} : 19 \text{ dB}$	2	5	100				
				$R_{thc} : 220^\circ C/W$		$f_T : 270 \text{ MHz}$	3	10					
AF126	PNP	Ampl. RF-FI oscill. fino a 27 MHz	$V_{CEO} : 15 V$	$P : 40 \text{ mW}$		$hFE : 140$	1	6					
			$VCBO : 32 V$	$T_a : 45^\circ C$		$\beta : 150$	1	6					
AF126	PNP	Ampl. RF-FI fino a 16 MHz	$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 75^\circ C$		$\gamma_{fb} : 150 \text{ mS}$	1	6	100				
				$R_{thc} : 400^\circ C/W$		$G_p : 14 \text{ dB}$	1	6	100				
AF127	PNP	Ampl. RF-FI fino a 6 MHz	$V_{CEO} : 15 V$	$P : 40 \text{ mW}$		$hFE : 140$	1	6					
			$VCBO : 32 V$	$T_a : 45^\circ C$		$\beta : 150$	1	6					
AF128	PNP	Ampl. RF per OM-OC C-18	$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 75^\circ C$		$\gamma_{fe} : 32 \text{ mS}$	1	6	10,7				
				$R_{thc} : 400^\circ C/W$		$G_p : 25 \text{ dB}$	1	6	10,7				
AF134	PNP	Ampl. RF per VHF TO-72L	$VCER : 18 V$	$P : 60 \text{ mW}$		$hFE : 140$	1	6					
			$(R_{BE} : 30 k\Omega)$	$T_a : 45^\circ C$		$\beta : 150$	1	6					
AF135	PNP	Ampl. RF per VHF TO-72L	$VCBO : 25 V$	$T_j : 75^\circ C$		$\gamma_{fe} : 37 \text{ mS}$	1	6	0,45				
			$(R_{BE} : 30 k\Omega)$	$T_a : 45^\circ C$		$G_p : 42 \text{ dB}$	1	6	0,45				
AF136	PNP	Ampl. RF oscill. conv. TO-72L	$VCER : 18 V$	$P : 60 \text{ mW}$		$hFE : 80$	1	6					
			$(R_{BE} : 30 k\Omega)$	$T_a : 45^\circ C$		$\gamma_{fe} : 36 \text{ mS}$	1	6	25				
AF137	PNP	Ampl. RF-FI per MA-MF TO-72L	$VCBO : 25 V$	$T_j : 75^\circ C$		$f_T : 40 \text{ MHz}$	1	6					
			$(R_{BE} : 30 k\Omega)$	$T_a : 45^\circ C$		$\beta : 60$	1	8					
AF138	PNP	Ampl. FI TO-72L	Dati tecnici come AF137 eccetto: $IC : 10 \text{ mA}$			$\gamma_{fe} : 36 \text{ mS}$	1	6	10,7				
						$f_T : 35 \text{ MHz}$	1	6					
AF139	PNP	Ampl. RF oscill. conv. UHF fino a 860 MHz TO-72	$V_{CEO} : 15 V$	$P : 60 \text{ mW}$		$hFE : 80$	2	6					
			$VCBO : 20 V$	$T_a : 45^\circ C$		$\gamma_{fe} : 14 \text{ mS}$	1	12	800				
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$		$G_{UM} : 14,8 \text{ dB}$	1,5	12	800				
						$f_T : 860 \text{ MHz}$	1,5	12					

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ C$)			CARATTERISTICHE a ($T_a = 25^\circ C$)			I_C (mA)	V_{CE} (V)	f (MHz)
AF142	PNP	Ampl. RF per MF TO-7	$VCBO : 30 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 100$	1,5	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$		$\gamma_{fb} : 18 \text{ mS}$	1	9	100		
AF143	PNP	Oscill. conv. per MF TO-7	$VCBO : 30 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 85$	1,5	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$		$\gamma_{fb} : 15 \text{ mS}$	1	9	100		
AF144	PNP	Ampl. FI per MA-MF TO-7	$VCBO : 30 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 65$	1,5	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$		$\gamma_{fe} : 37 \text{ mS}$	1	6	10,7		
AF146	PNP	Oscill. conv. per OM-OC TO-7	$VCBO : 30 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 100$	1	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$							
AF147	PNP	Ampl. RF per MA TO-7	$VCBO : 24 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 80$	1	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$							
AF148	PNP	Oscill. conv. per OM-OC TO-7	$VCBO : 24 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 100$	1	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$							
AF149	PNP	Ampl. FI per MA TO-7	Dati tecnici come AF171								
AF150	PNP	Ampl. FI per MA TO-7	$VCBO : 24 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 70$	1	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 90^\circ C$		$\gamma_{fe} : 37 \text{ mS}$	1	9	0,45		
AF164	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF142								
AF165	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF143								
AF166	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF144								
AF168	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF146								
AF169	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF147								
AF170	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF148								
AF171	PNP	Ampl. FI per MA TO-44	$VCBO : 24 V$	$P : 80 \text{ mW}$		$\beta : 225$	1	6			
			$IC : 10 \text{ mA}$	$T_j : 75^\circ C$		$G_{UM} : 34,5 \text{ dB}$	1	6	0,45		
AF172	PNP	TO-44	Impiego e dati tecnici come AF150								

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE a			
						IC (mA)	VCE (V)	f (MHz)	
AF178	PNP oscill. conv. VHF	Ampl. RF oscill. conv. VHF	VCEO : 25 V	P : 50 mW		hFE : > 20	1	12	
			IC : 10 mA	Ta : 45 °C		β : > 20	1	12	
AF179	PNP TO-12	Ampl. FI video TV	VCEO : 25 V	P : 95 mW		Yfe : 80 mS	3	10	
			VCBO : 25 V	Tj : 80 °C		fT : 270 MHz	3	10	
AF180	PNP TO-12	Ampl. RF per VHF	VCEO : 25 V	P : 0,156 mW		Yfb : 35 mS	3,5	10	
			VCBO : 25 V	Tj : 75 °C		Gp : 14 dB	3,5	10	
AF181	PNP TO-12	Ampl. FI video TV	VCE : 30 V	P : 0,156 mW		hFE : 60	3	10	
			VCBO : 30 V	Tj : 75 °C		Yfe : 85 mS	3	10	
AF186	PNP TO-72L	Preampl. RF (punto nero) e conv. oscill.	IC : 20 mA	Rthc : 140 °C/W		fT : 170 MHz	3	10	
			VCEO : 25 V	Ta : 45 °C		Gp : 9 dB	2	10	
AF200	PNP TO-72LR	Ampl. FI video TV	VCBO : 25 V	Ta : 45 °C		fT : 820 MHz	2	10	
			IC : 10 mA	Tj : 90 °C		Yfb : 18 mS	2	10	
AF201	PNP TO-72LR	Ampl. FI video TV	Vces : 25 V	P : 0,1 W		hFE : > 30	3	10	
			VCBO : 25 V	Ta : 45 °C		β : 150	3	10	
AF202	PNP TO-72LR	Ampl. FI video TV	IC : 10 mA	Tj : 90 °C		Yfe : 92 mS	3	10	
			Rthc : 200 °C/W					35	
AF202S	PNP TO-72LR	Ampl. FI video TV	Vces : 32 V	P : 0,1 W		hFE : > 20	3	10	
			VCBO : 32 V	Ta : 45 °C		β : 150	3	10	
AF239	PNP TO-72	Ampl. RF oscill. conv. UHF	IC : 30 mA	Tj : 90 °C		Yfe : 95 mS	3	10	
			Rthc : 200 °C/W					35	
AF239S	PNP TO-72	Ampl. RF oscill. conv. UHF	VCEO : 15 V	P : 60 mW		hFE : 33	2	10	
			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C		Yfb : 20 mS	2	10	
AF240	PNP TO-72	Ampl. RF oscill. VHF-UHF	IC : 10 mA	Tj : 90 °C		GUM : 17 dB	2	10	
			fT : 650 MHz			fT : 800			
AF251	PNP MM-12	Ampl. RF per UHF	VCEO : 15 V	P : 90 mW		hFE : 30	2	12	
			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C		fT : 750 MHz	2	12	
AF251	PNP MM-12	Ampl. RF per UHF	IC : 10 mA	Tj : 90 °C					

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE a			
						IC (mA)	VCE (V)	f (MHz)	
AF252	PNP MM-12 A	Oscill. conv. UHF	VCEO : 15 V	P : 90 mW		hFE : > 10	2	12	
			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C		fT : 650 MHz	2	12	
AF253	PNP MM-12 A	Ampl. RF per UHF	VCEO : 15 V	P : 90 mW		hFE : > 10	2	12	
			VCBO : 20 V	Ta : 45 °C		fT : 550 MHz	2	12	
AF256	PNP MM-12A	Ampl. RF oscill. VHF	VCEO : 18 V	P : 90 mW		hFE : 28	1	12	
			VCBO : 25 V	Ta : 45 °C		fT : > 170 MHz	1	12	
AF279	PNP TO-50	Ampl. RF oscill. UHF	VCEO : 15 V	P : 60 mW		hFE : 50	2	10	
			VCBO : 20 V	Ta : 55 °C		fT : 780 MHz	2	10	
AF280	PNP TO-50	Ampl. RF oscill. UHF	VCEO : 15 V	P : 60 mW		hFE : 25	2	10	
			VCBO : 20 V	Ta : 55 °C		fT : 550 MHz	2	10	
AFY12	PNP TO-72	Ampl. RF oscill. VHF	VCEO : 12 V	P : 112 mW		hFE : 25 - 120	1	12	
			IC : 10 mA	Tc : 45 °C		fT : 230 MHz			
AFY16	PNP TO-72	Ampl. RF per UHF	VCBO : 30 V	P : 112 mW		hFE : > 10	1,5	12	
			IC : 10 mA	Tc : 45 °C		fT : 550 MHz			
AL100	PNP TO-3	Commutazione alta velocità	VCEO : 40 V	P : 50 W		hFE : 40-250	1000	1	
			VCBO : 100 V	Tc : 25 °C		fT : 7,5 MHz	1000	1	
AL101	PNP TO-3	Commutazione alta velocità	VCEO : 40 V	P : 50 W		hFE : 40-250	1000	1	
			VCBO : 60 V	Tc : 25 °C		fT : 7,5 MHz	1000	1	
AL102	PNP TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO : 50 V	P : 12,5 W		hFE : 40-250	1000	1	
			VCBO : 75 V	Tc : 81 °C		β : 150	1000	1	
AL103	PNP TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	IC : 5 A	Tj : 100 °C		fT : 4 MHz			
			VCEO : 40 V	P : 12,5 W		hFE : 40-250	1000	1	
AL112	PNP SOT-9	Ampl. di potenza Commutazione	VCBO : 60 V	P : 10 W		hFE : 30-180	500	2	
			IC : 6 A	Tc : 60 °C		fT : 3 MHz			
AL113	PNP SOT-9	Ampl. di potenza Commutazione	VCEO : 40 V	P : 10 W		hFE : 40-180	500	2	
			VCBO : 100 V	Tc : 60 °C		fT : 3 MHz			
ASY26	PNP TO-5	Commutazione	VCEO : 15 V	P : 0,15 W		hFE : > 30	20	1	
			VCBO : 30 V	Tj : 85 °C		fT : 8 MHz	3	5	

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
ASY27	PNP	TO - 5	Impiego e dati tecnici come ASY26 eccetto: $V_{CEO} : 25\text{ V}$	$h_{FE} : >50$ $f_T : 14\text{ MHz}$ $t_{on} : 250\text{ ns}$ $t_{off} : 1000\text{ ns}$		20	1
						3	5
ASY28	NPN	Commutazione TO - 5	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $P : 0,15\text{ W}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $T_c : 85^\circ\text{C}$ $I_C : 0,2\text{ A}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : >30$ $f_T : 14\text{ MHz}$ $t_{on} : 225\text{ ns}$ $t_{off} : 775\text{ ns}$		20	1
						3	5
ASY29	NPN	TO - 5	Impiego e dati tecnici come ASY28 eccetto: $V_{CEO} : 25\text{ V}$	$h_{FE} : >50$ $f_T : 20\text{ MHz}$ $t_{on} : 185\text{ ns}$ $t_{off} : 800\text{ ns}$		20	1
						3	5
ASY75	NPN	Commutazione TO - 5	$V_{CEO} : 15\text{ V}$ $P : 0,14\text{ W}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $T_c : 75^\circ\text{C}$ $I_C : 0,4\text{ A}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : >50$ $f_T : 10\text{ MHz}$		200	1
						3	5
ASZ15	PNP	Commutazione Circuiti alim. TO - 3	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ $P : 30\text{ W}$ $V_{CBO} : 100\text{ V}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $I_C : 8\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 1,5^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : 20 - 55$ $f_T : 0,2\text{ MHz}$		1000	1
						1000	5
ASZ16	PNP	Commutazione Circuiti alim. TO - 3	$V_{CEO} : 32\text{ V}$ $P : 30\text{ W}$ $V_{CBO} : 60\text{ V}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $I_C : 8\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 1,5^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : 45 - 130$ $f_T : 0,25\text{ MHz}$		1000	1
						1000	5
ASZ17	PNP	TO - 3	Impiego e dati tecnici come ASZ16 eccetto: $V_{CEO} : 25\text{ V}$	$h_{FE} : 25 - 75$ $f_T : 0,22\text{ MHz}$		1000	1
						1000	5
ASZ18	PNP	TO - 3	Impiego e dati tecnici come ASZ17 eccetto: $V_{CBO} : 100\text{ V}$	$h_{FE} : 30 - 110$		1000	1
AU101	PNP	Ampl. uscita orizz. TV TO - 3	$V_{CEO} : 120\text{ V}$ $P : 10\text{ W}$ $V_{CBO} : 120\text{ V}$ $T_c : 70^\circ\text{C}$ $I_C : 10\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 2^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : 12 - 50$ $f_T : >0,4\text{ MHz}$		10 A	
						500	2
AU103	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CEX} : 155\text{ V}$ $P : 10\text{ W}$ $V_{CBO} : 155\text{ V}$ $T_c : 75^\circ\text{C}$ $I_C : 10\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 1,5^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : >15$ $f_T : 15\text{ MHz}$		10 A	2
						600	2
AU104	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CEX} : 185\text{ V}$ $P : 15\text{ W}$ $V_{CBO} : 185\text{ V}$ $T_c : 67,5^\circ\text{C}$ $I_C : 12\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 1,5^\circ\text{C/W}$	$h_{FE} : >15$ $f_T : 15\text{ MHz}$		10 A	1
						500	2
AU106	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 320\text{ V}$ $P : 23\text{ W}$ $T_c : 55^\circ\text{C}$ $I_C : 10\text{ A}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$	$h_{FE} : 15 - 80$ $f_T : 2\text{ MHz}$		6000	1,3

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)	
AU107	PNP	Deflessione vert. TV TO - 3	$V_{CBO} : 200\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 30\text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 35 - 120$ $f_T : 2\text{ MHz}$	700	2
AU108	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 100\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 30\text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 35 - 200$	700	2
AU108F	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 100\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 30\text{ W}$ $T_c : 45^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 120 - 250$	1000	2
AU110	PNP	Ampl. finale TV TO - 3	$V_{CBO} : 160\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 30\text{ W}$ $T_c : 55^\circ\text{C}$ $T_j : 100^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 20 - 90$	1000	2
AU111	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 320\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 23\text{ W}$ $T_c : 55^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 15 - 80$ $f_T : 2\text{ MHz}$	6000	1,3
AU112	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 320\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 23\text{ W}$ $T_c : 55^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 15 - 40$ $f_T : 2\text{ MHz}$	6000	1,3
AU113	PNP	Deflessione orizz. TV TO - 3	$V_{CBO} : 250\text{ V}$ $I_C : 10\text{ A}$	$P : 23\text{ W}$ $T_c : 55^\circ\text{C}$ $T_j : 90^\circ\text{C}$		$h_{FE} : 15 - 80$	6000	1,3
BC107	NPN	Preampl. e pilota BF TO - 18	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CBO} : 50\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$		$A h_{FE} : 180$ $B h_{FE} : 290$ $f_T : 300\text{ MHz}$	10	5
BC108	NPN	Preampl. e pilota BF TO - 18	$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$		$A h_{FE} : 180$ $B h_{FE} : 290$ $C h_{FE} : 520$ $f_T : 300\text{ MHz}$	10	5
BC109	NPN	Preampl. BF basso rumore TO - 18	$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$		$B h_{FE} : 290$ $C h_{FE} : 520$ $f_T : 300\text{ MHz}$	10	5
BC110	NPN	Ampl. BF uso generale TO - 18	$V_{CEO} : 80\text{ V}$ $V_{CBO} : 80\text{ V}$ $I_C : 50\text{ mA}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$		$h_{FE} : >30$ $f_T : 100\text{ MHz}$	10	5
BC113	NPN	Preampl. BF TO - 106	$V_{CEO} : 25\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $I_C : 50\text{ mA}$	$P : 0,2\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200^\circ\text{C/W}$		$h_{FE} : 350$ $\beta : 350$ $f_T : 60\text{ MHz}$	1	5
BC114	NPN	Preampl. BF basso rumore TO - 106		Dati tecnici come BC113				
BC115	NPN	Preampl. e pilota BF TO - 105	$V_{CEO} : 30\text{ V}$ $V_{CBO} : 40\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 125^\circ\text{C/W}$		$h_{FE} : 145$ $\beta : 170$ $f_T : 40\text{ MHz}$	1	10

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)			CARATTERISTICHE a			I_c	V_{CE}	f
						hFE	β	f_T	(mA)	(V)	(MHz)
BC116	PNP	Impiego generale	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 0,3\text{ W}$		$\text{hFE} : 100$			10	1	
			$V_{CBO} : 45\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 2$			30	10	100
BC117	NPN	Impiego generale alta tensione	$V_{CEO} : 120\text{ V}$	$P : 0,3\text{ W}$		$\text{hFE} : 50$			10	10	
			$V_{CBO} : 120\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 50$			10	5	
BC118	NPN	Impiego generale	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 0,2\text{ W}$		$\text{hFE} : 40 - 160$			10	10	
			$V_{CBO} : 45\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 3,5$			10	15	100
BC119	NPN	Ampl. uscita BF	$V_{CEO} : 30\text{ V}$	$P : 0,8\text{ W}$		$\text{hFE} : 100$			50	1	
			$V_{CBO} : 60\text{ V}$	$T_j : 200^\circ\text{C}$		$\beta : >2$			50	10	20
BC120	NPN	Pilota orizz. e vert. TV	$V_{CEO} : 30\text{ V}$	$P : 0,8\text{ W}$		$\text{hFE} : 70$			10	10	
			$V_{CBO} : 60\text{ V}$	$T_j : 200^\circ\text{C}$		$\beta : >2$			50	10	20
BC125	NPN	Ampl. pilota BF compl. BC126	$V_{CEO} : 30\text{ V}$	$P : 0,3\text{ W}$		$\text{hFE} : 50$			1	1	
			$V_{CBO} : 50\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : >2$			50	10	20
BC126	PNP	Ampl. pilota BF compl. BC125	Dati tecnici come BC125 eccetto: $V_{CBO} : 35\text{ V}$			$\text{hFE} : 62$			1	1	
			$\text{f}_T : 200\text{ MHz}$								
BC129	NPN	Ampl. pilota BF basso rumore	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 135\text{ mW}$		$\text{hFE} : 220$			2	5	
			$V_{CBO} : 50\text{ V}$	$T_a : 45^\circ\text{C}$		A $\beta : 125 - 260$			2	5	
BC130	NPN	Ampl. pilota BF basso rumore	$V_{CEO} : 20\text{ V}$	$P : 135\text{ mW}$		$\text{hFE} : 220$			2	5	
			$V_{CBO} : 30\text{ V}$	$T_a : 45^\circ\text{C}$		A $\beta : 125 - 260$			2	5	
BC131	NPN		Impiego e dati tecnici come BC130 eccetto: $V_{CEO} : 25\text{ V}$			$\text{hFE} : 400$			2	5	
			$B \beta : 240 - 500$						2	5	
BC132	NPN	Ampl. BF	$V_{CEO} : 25\text{ V}$	$P : 0,2\text{ W}$		$\text{hFE} : 220$			1	10	
			$V_{CBO} : 30\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 240$			1	5	
BC134	NPN	Impiego generale	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 0,2\text{ W}$		$\text{hFE} : 250$			10	10	
			$V_{CBO} : 45\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 230$			5	10	
BC138	PNP	Ampl. uscita BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 0,7\text{ W}$		$\text{hFE} : 90$			10	10	
			$V_{CBO} : 40\text{ V}$	$T_j : 200^\circ\text{C}$		$\beta : 2$			50	10	100
BC139	TO-39		$I_C : 0,5\text{ A}$	$R_{thc} : 58,3^\circ\text{C/W}$		$\text{f}_T : 40\text{ MHz}$					

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)			CARATTERISTICHE a			I_c	V_{CE}
						hFE	β	f_T	(mA)	(V)
BC140	NPN	Ampl. BF basso rumore commut. rapida	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 3,7\text{ W}$		6 $\text{hFE} : 40 - 100$			100	
			$V_{CBO} : 80\text{ V}$	$T_c : 45^\circ\text{C}$		10 $\text{hFE} : 83 - 160$			100	
BC141	TO-39		$I_C : 1\text{ A}$	$T_j : 175^\circ\text{C}$		16 $\text{hFE} : 100 - 250$			100	
			$R_{thc} : 220^\circ\text{C/W}$			$\text{f}_T : >60$			50	10
BC142	NPN	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC143	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 0,8\text{ W}$		$\text{hFE} : 80$			200	
			$V_{CBO} : 70\text{ V}$			$\text{f}_T : 40\text{ MHz}$				
BC143	PNP	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC142	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 0,8\text{ W}$		$\text{hFE} : 70$			200	
			$V_{CBO} : 60\text{ V}$			$\text{f}_T : 100\text{ MHz}$				
BC144	NPN	Ampl. pilota ed uscita BF compl. BC139	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 0,8\text{ W}$		$\text{hFE} : 40$			300	
			$V_{CBO} : 60\text{ V}$			$\text{f}_T : 40\text{ MHz}$				
BC147	NPN	Ampl. pilota BF compl. BC157	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 0,25\text{ W}$		A $\text{hFE} : 180 \quad \beta : >125$	2		5	
			$V_{CBO} : 50\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		B $\text{hFE} : 290 \quad \beta : >240$	2		5	
BC148	NPN	Preampl. e pilota BF compl. BC158	$V_{CEO} : 20\text{ V}$	$P : 0,25\text{ W}$		A $\text{hFE} : 180 \quad \beta : >125$	2		5	
			$V_{CBO} : 30\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		B $\text{hFE} : 290 \quad \beta : >240$	2		5	
BC149	NPN	Preampl. BF basso rumore compl. BC159	$V_{CEO} : 20\text{ V}$	$P : 0,25\text{ W}$		C $\text{hFE} : 520 \quad \beta : >470$	2		5	
			$V_{CBO} : 30\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\text{f}_T : 300\text{ MHz}$	10		6	
BC163	PNP	Preampl. e pilota BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 0,2\text{ W}$		$\text{hFE} : 135$			1	5
			$V_{CBO} : 40\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		$\beta : 135$			1	5
BC154	PNP	Preampl. BF alto guadagno basso rumore	$V_{CEO} : 20\text{ V}$	$P : 0,25\text{ W}$		$\text{hFE} : 230$			1	5
						$\beta : 230$			1	5
BC155	NPN	Ampl. BF	$V_{CEO} : 5\text{ V}$	$P : 105\text{ mW}$		A $\beta : 85 - 220$	0,5		1	
			$V_{CBO} : 5\text{ V}$	$T_a : 45^\circ\text{C}$		B $\beta : 200 - 500$	0,5		1	
BC156	TOM-13		$I_C : 50\text{ mA}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		C $\beta : 470 - 900$	0,5		1	
						$\text{f}_T : >50\text{ MHz}$	2		5	
BC157	NPN	Ampl. BF	$V_{CEO} : 5\text{ V}$	$P : 50\text{ mW}$		A $\beta : 85 - 220$	0,5		1	
			$V_{CBO} : 5\text{ V}$	$T_a : 45^\circ\text{C}$		B $\beta : 200 - 500$	0,5		1	
BC158	TOM-23		$I_C : 50\text{ mA}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		C $\beta : 470 - 900$	0,5		1	
						$\text{f}_T : >50\text{ MHz}$	2		5	
BC159	PNP	Ampl. pilota BF compl. BC147	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 0,25\text{ W}$		V $\text{hFE} : 140 \quad \beta : >75$	2		5	
			$V_{CBO} : 50\text{ V}$	$T_j : 125^\circ\text{C}$		A $\text{hFE} : 180 \quad \beta : >125$	2		5	
BC160	TOM-23		$I_C : 0,1\text{ A}$			$\text{f}_T : 150\text{ MHz}$	10		5	

Dati Transistori 2

3

(47 RSTT)

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	a	I_C (mA)	V_{CE} (V)	
BC168	PNP SOT-25 MM - 12	Preampl. e pilota BF compl. BC148	$V_{CEO} : 25\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,25\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	VI A B f _T	$hFE : 140 \quad \beta : > 75$ $hFE : 180 \quad \beta : > 125$ $hFE : 290 \quad \beta : > 240$ $f_T : 150\text{ MHz}$	2 2 2 10	5 5 5 5
BC159	PNP SOT-25 MM - 12	Preampl. BF basso rumore compl. BC148	$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CBO} : 25\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,25\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	A B f _T	$hFE : 180 \quad \beta : > 125$ $hFE : 290 \quad \beta : > 240$ $f_T : 150\text{ MHz}$	2 2 10	5 5 5
BC167	NPN TO - 92B MM - 11B	Preampl. e pilota BF basso rumore compl. BC257	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CBO} : 50\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,22\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	A B f _T	$hFE : 220 \quad \beta : 125 - 260$ $\beta : 240 - 500$ $f_T : 300\text{ MHz}$	2 2 10	5 5 5
BC168	NPN TO - 92B MM - 11B	Preampl. e pilota BF basso rumore compl. BC158	$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,22\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	A B C f _T	$hFE : 220 \quad \beta : 125 - 260$ $\beta : 240 - 500$ $\beta : 470 - 900$ $f_T : 300\text{ MHz}$	2 2 2 10	5 5 5 5
BC169	NPN TO - 92B MM - 11B	Preampl. e pilota BF basso rumore compl. BC259		Dati tecnici come BC168 eccetto:	A B C	$hFE : 400$ $\beta : 240 - 500$ $\beta : 470 - 900$	2 2 2	5 5 5
BC170	NPN	Ampl. RF - FI per AM - OC Commutazione		$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $P : 0,2\text{ W}$	A B C f _T	$hFE : 35 - 100$ $hFE : 35 - 100$ $hFE : 80 - 250$ $hFE : 200 - 600$ $f_T : 100\text{ MHz}$	1 1 1 1	
BC171	NPN	Ampl. RF - FI per AM - OC		$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $P : 0,2\text{ W}$	A B f _T	$hFE : 275$ $hFE : 225$ $hFE : 350$ $f_T : 300\text{ MHz}$	2 20 20	
BC172	NPN	Ampl. RF - FI per AM - OC		$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $P : 0,2\text{ W}$	A B C f _T	$hFE : 225$ $hFE : 225$ $hFE : 350$ $hFE : 620$ $f_T : 300\text{ MHz}$	20 20 20 20	
BC177	PNP	Preampl. e pilota BF compl. BC107	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CBO} : 50\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 200\text{ }^\circ\text{C/W}$	VI A B f _T	$hFE : 75 \quad \beta : > 50$ $hFE : 140 \quad \beta : > 75$ $hFE : 180 \quad \beta : > 125$ $hFE : 290 \quad \beta : > 240$ $f_T : 130\text{ MHz}$	2 2 2 2 10	5 5 5 5 5
BC178	PNP TO - 18	Preampl. e pilota BF compl. BC108		Dati tecnici come BC177 eccetto: $V_{CEO} : 25\text{ V}$ $V_{CBO} : 30\text{ V}$				
BC179	PNP TO - 18	Preampl. BF basso rumore compl. BC109		$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CBO} : 25\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	A B f _T	$hFE : 180 \quad \beta : > 125$ $hFE : 290 \quad \beta : > 240$ $f_T : 130\text{ MHz}$	2 2 10	5 5 5

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)			a	Ic (mA)	Vce (V)
BC183	NPN TO-18	Ampl. RF - MF	Vceo : 30 V	P : 0,3 W		hFE : < 85		2			
						fT : 150 MHz					
BC194	NPN TOM-13	Applicazioni generali RF Commutazione	Vceo : 25 V	P : 0,1 W		hFE : > 25	1	10			
			Vcbo : 40 V	Ta : 45 °C		fT : > 250 MHz	20	10			
BC197	NPN TOM-23	Impiego generale BF	Vceo : 45 V	P : 50 mW		hFE : 220	2	5			
			Vcbo : 50 V	Ta : 45 °C		A β : 125 - 260	2	5			
			Ic : 0,1 A	Tj : 125 °C		B β : 240 - 500	2	5			
						fT : 300 MHz	10	5			
BC198	NPN TOM-23	Impiego e dati tecnici come BC197 eccetto:	Vceo : 20 V			A β : 125 - 260	2	5			
			Vcbo : 30 V			B β : 240 - 500	2	5			
						C β : 470 - 900	2	5			
						fT : 300 MHz	10	5			
BC199	NPN TOM-23	Impiego generale BF	Vceo : 20 V	P : 50 mW		hFE : 400	2	5			
			Vcbo : 30 V	Ta : 45 °C		B β : 240 - 500	2	5			
			Ic : 0,1 A	Tj : 125 °C		C β : 470 - 900	2	5			
						fT : 300 MHz	10	5			
BC204	PNP TO-92 TO-106 RO-110	Preampl. e pilota BF	Vceo : 45 V	P : 0,3 W		V hFE : 75 β : > 50	2	5			
			Vcbo : 45 V	Tj : 125 °C		VI hFE : 110 β : > 75	2	5			
			Ic : 0,1 A			A hFE : 180 β : > 125	2	5			
						B hFE : 290 β : > 240	2	5			
						fT : 200 MHz	10	5			
BC205	PNP TO-92 TO-106 RO-110	Preampl. e pilota BF	Dati tecnici come BC204 eccetto:								
			Vceo : 20 V								
			Vcbo : 20 V								
BC206	PNP TO-92 basso rumore TO-106 RO-110	Preampl. BF	Vceo : 20 V	P : 0,3 W	B	hFE : 290	2	5			
			Vcbo : 20 V	Tj : 125 °C		β : > 240	2	5			
			Ic : 0,1 A			fT : 200 MHz	10	5			
BC207	NPN TO-92 pilota BF TO-106 RO-110	Preampl. e pilota BF	Vceo : 45 V	P : 0,3 W	A	hFE : 180 β : 200	2	5			
			Vcbo : 45 V	Tj : 125 °C	B	hFE : 290 β : 330	2	5			
			Ic : 0,1 A			β : 200 - 330	2	5			
						fT : 300 MHz	10	5			
BC208	NPN TO-92 pilota BF TO-106 RO-110	Preampl. e pilota BF	Vceo : 20 V	P : 0,3 W	A	hFE : 180 β : 200	2	5			
			Vcbo : 20 V	Tj : 125 °C	B	hFE : 290 β : 330	2	5			
			Ic : 0,1 A		C	hFE : 520 β : 600	2	5			
						fT : 300 MHz	10	5			
BC209	NPN TO-92 basso rumore TO-106 RO-110	Preampl. BF	Vceo : 20 V	P : 0,3 W	B	hFE : 290 β : 330	2	5			
			Vcbo : 20 V	Tj : 125 °C	C	hFE : 520 β : 600	2	5			
			Ic : 0,1 A			fT : 300 MHz	10	5			
BC210	NPN TO-18	Pilota orizz. e vert. TV	Vceo : 25 V	P : 0,45 W		hFE : 30 - 140	10	1			
			Vcbo : 50 V	Tj : 175 °C		fT : 250 MHz	20	10			
			Ic : 0,7 A			Rthc : 100 °C/W					
						t _{on} : 30 ns	150				
						t _{off} : 180 ns	150				

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)			a	Ic (mA)	Vce (V)
BC210A	NPN TO-5	Pilota orizz. e vert. TV	Vceo : 25 V	P : 0,6 W		hFE : 30 - 140	10	1			
			Vcbo : 50 V	Tj : 175 °C		fT : 250 MHz	20	10			
			Ic : 0,7 A			Rthc : 60 °C/W					
						t _{on} : 30 ns	150				
						t _{off} : 180 ns	150				
BC211	NPN TO-5	Pilota orizz. e vert. TV	Vceo : 40 V	P : 0,8 W		hFE : 70	10	1			
			Vcbo : 80 V	Tj : 175 °C		fT : 200 MHz	50	10			
			Ic : 1 A			Rthc : 35 °C/W					
						t _{on} : 30 ns	150				
						t _{off} : 180 ns	150				
BC215	PNP TO-18	Impiego generale	Vceo : 30 V	P : 0,4 W		A hFE : 40 - 120	150	10			
			Vcbo : 50 V	Tj : 200 °C		B hFE : 100 - 300	150	10			
			Ic : 0,5 A			Rthc : 140 °C/W					
						fT : 200 MHz	30	10			
BC225	PNP TO-106	Preampl. e pilota BF	Vceo : 40 V	P : 0,2 W		hFE : 170	1	5			
			Vcbo : 40 V	Tj : 125 °C		β : 185	1	5			
			Ic : 0,1 A			Rthc : 200 °C/W					
BC236	NPN TO-110	Impiego generale alta tensione	Vcbo : 120 V	P : 0,3 W		hFE : > 25	10	10			
			Ic : 50 mA	Tj : 125 °C		β : > 25	10	5			
BC237	NPN TO-92 MM-11		Impiego e dati tecnici come BC147 eccetto:			P : 0,3 W					
BC238	NPN TO-92 MM-11		Impiego e dati tecnici come BC148 eccetto:			P : 0,3 W					
BC239	NPN TO-92 MM-11		Impiego e dati tecnici come BC149 eccetto:			P : 0,3 W					
BC257	PNP TO-92B	Preampl. e pilota BF compl. BC167	Vceo : 45 V	P : 0,22 W		VI hFE : 110 β : > 75	2				
			Vcbo : 50 V	Tj : 125 °C		A hFE : 180 β : > 125	2				
			Ic : 0,1 A			fT : 130 MHz	10	5			
BC258	PNP TO-92B	Preampl. e pilota BF compl. BC168	Vceo : 25 V	P : 0,22 W		VI hFE : 110 β : > 75	2				
			Vcbo : 30 V	Tj : 125 °C		A hFE : 180 β : > 125	2				
			Ic : 0,1 A			B hFE : 290 β : > 240	2				
						fT : 130 MHz	10	5			
BC259	PNP TO-92B	Preampl. e pilota BF compl. BC169	Vceo : 20 V	P : 0,22 W		A hFE : 180 β : > 125	2				
			Vcbo : 25 V	Tj : 125 °C		B hFE : 290 β : > 240	2				
			Ic : 0,1 A			fT : 130 MHz	10	5			
BC267	NPN TO-18	Ampl. pilota BF Commutazione	Vceo : 45 V	P : 0,375 W		β : 125 - 500	2	5			
			Vcbo : 50 V	Tj : 175 °C		fT : 200 MHz					
			Ic : 0,5 A								
BC268	NPN TO-18	Ampl. pilota BF alto guadagno Commutazione	Vceo : 20 V	P : 0,375 W		β : 125 - 900	2	5			
			Vcbo : 30 V	Tj : 175 °C		fT : 200 MHz					
			Ic : 0,5 A								
BC269	NPN TO-18	Preampl. BF basso rumore Commutazione	Dati tecnici come BC268 eccetto:			β : 240 - 900	2	5			

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
BC270	NPN TO-18	Ampl. pilota BF Commutazione	Dati tecnici come BC268 eccetto: $V_{CEO} : 20\text{ V}$	$\beta : 50 - 900$		2	5
BC280	NPN TO-18	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 40\text{ V}$ $V_{CB0} : 45\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 146^\circ\text{C/W}$	A $hFE : 200$ B-C $hFE : 350$ C $hFE : 250$	$\beta : 220$ $\beta : 370$ $\beta : 250$	1 1 1
BC281	PNP TO-18	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CB0} : 45\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 146^\circ\text{C/W}$	A $hFE : 120$ B $hFE : 200$ C $hFE : 250$	$\beta : 130$ $\beta : 200$ $\beta : 250$	1 1 1
BC282	NPN TO-18	Ampl. pilota e finale BF compl. BC283	$V_{CEO} : 30\text{ V}$ $V_{CB0} : 60\text{ V}$ $I_C : 0,6\text{ A}$	$P : 0,4\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 134^\circ\text{C/W}$	$hFE : 150$	50	5
BC283	PNP TO-18	Ampl. pilota e finale BF compl. BC282	$V_{CEO} : 30\text{ V}$ $V_{CB0} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,6\text{ A}$	$P : 0,4\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 134^\circ\text{C/W}$	$hFE : 130$ $hFE : 110$	50	5
BC284	NPN TO-18	Ampl. pilota BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$ $V_{CB0} : 40\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,5\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 97^\circ\text{C/W}$	A $hFE : 230$ B $hFE : 350$	$\beta : 265$ $\beta : 390$	10 10
BC285	NPN TO-18	Preampl. e pilota BF alta tensione	$V_{CEO} : 120\text{ V}$ $V_{CB0} : 120\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 146^\circ\text{C/W}$	$hFE : 70$	5 5	30 30
BC286	NPN TO-39	Ampl. uscita BF	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ ($R_{BE} < 200\ \Omega$) $V_{CB0} : 70\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	$P : 0,8\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 43,7^\circ\text{C/W}$	$hFE : 170$ $hFE : 120$	10 100	2 2
BC287	PNP TO-39	Ampl. uscita BF	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ $V_{CB0} : 60\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	$P : 0,8\text{ W}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 43,7^\circ\text{C/W}$	$hFE : 90$ $hFE : 90$	100 100	2 2
BC288	NPN TO-39	Ampl. uscita BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$ $V_{CB0} : 80\text{ V}$ $I_C : 5\text{ A}$	$P : 0,8\text{ A}$ $T_j : 200^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 25^\circ\text{C/W}$	$hFE : 150$	100	2
BC297	PNP TO-18	Ampl. pilota o finale BF Commutazione	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CB0} : 50\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	$P : 0,375\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$	$hFE : 75 - 260$ $f_T : 150\text{ MHz}$	100	1
BC298	PNP TO-18	Ampl. pilota o finale BF Commutazione	$V_{CEO} : 25\text{ V}$ $V_{CB0} : 30\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	$P : 0,375\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$	$hFE : 75 - 500$ $f_T : 150\text{ MHz}$	100	1
BC300	NPN TO-39	Ampl. pilota BF Commutazione	$V_{CEO} : 80\text{ V}$ $V_{CB0} : 120\text{ V}$ $I_C : 0,5\text{ A}$	$P : 6\text{ W}$ $T_c : 25^\circ\text{C}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$	$hFE : 40 - 240$ $f_T : 120\text{ MHz}$	150	10
BC301	NPN TO-39	Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: $V_{CEO} : 60\text{ V}$ $V_{CB0} : 90\text{ V}$					

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	CARATTERISTICHE ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	α	I_C (mA)	V_{CE} (V)
BC302	NPN TO-39	Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: $V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CB0} : 60\text{ V}$					
BC303	PNP TO-39	Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: $V_{CEO} : 60\text{ V}$ $V_{CB0} : 85\text{ V}$					$f_T : 75\text{ MHz}$
BC304	PNP TO-39	Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: $V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CB0} : 60\text{ V}$					$f_T : 75\text{ MHz}$
BC307	PNP TO-92	Ampl. BF	$V_{CEO} : 45\text{ V}$ $V_{CB0} : 50\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	VII $hFE : 75 - 150$ A $hFE : 125 - 260$ $f_T : 150\text{ MHz}$	2 2 10	5 5 6
BC308	PNP TO-92	Ampl. BF	$V_{CEO} : 25\text{ V}$ $V_{CB0} : 30\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	VII $hFE : 75 - 150$ A $hFE : 125 - 260$ B $hFE : 240 - 500$ $f_T : 150\text{ MHz}$	2 2 10 5	5 5 5 5
BC309	PNP TO-92	Ampl. BF	$V_{CEO} : 20\text{ V}$ $V_{CB0} : 25\text{ V}$ $I_C : 0,1\text{ A}$	$P : 0,3\text{ W}$ $T_j : 125^\circ\text{C}$	A $hFE : 125 - 260$ B $hFE : 240 - 500$ $f_T : 150\text{ MHz}$	2 2 10	5 5 5
BC313	PNP TO-5	Pilota orizz. e vert. TV uscita BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$ $V_{CB0} : 70\text{ V}$ $I_C : 1\text{ A}$	$P : 0,8\text{ W}$ $T_j : 175^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 35^\circ\text{C/W}$	$hFE : 70$ $f_T : 200\text{ MHz}$	10 50	1 10
BC317	NPN TO-92A	Preampl. BF	$V_{CEO} : 45\text{ V}$		A $hFE : 125 - 500$ B $hFE : 125 - 260$ B $hFE : 240 - 500$	2 2 2	
BC318	NPN TO-92A	Preampl. BF	$V_{CEO} : 30\text{ V}$		A $hFE : 125 - 900$ A $hFE : 125 - 260$ B $hFE : 240 - 500$	2 2 2	
BC318C	NPN TO-92A	Preampl. BF	$V_{CEO} : 20\text{ V}$		$hFE : 450 - 900$	2	
BC319	NPN TO-92A	Preampl. BF	$V_{CEO} : 20\text{ V}$		B $hFE : 240 - 900$ B $hFE : 250 - 500$ C $hFE : 450 - 900$	2 2 2	
BC323	NPN TO-39	Ampl. finale vert. TV	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ $V_{CB0} : 100\text{ V}$				
BC324	NPN TO-39	Ampl. finale vert. TV	$V_{CEO} : 55\text{ V}$ $V_{CB0} : 85\text{ V}$				
BC327	PNP TO-92	Ampl. finale BF compl. BC337	$V_{CES} : 50\text{ V}$ $V_{CEO} : 45\text{ V}$ $I_C : 0,5\text{ A}$	$P : 0,5\text{ W}$ $T_j : 150^\circ\text{C}$ $R_{thc} : 170^\circ\text{C/W}$	$hFE : 100 - 600$ $f_T : 100\text{ MHz}$	100 10	1 5

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	Ia (mA)	IC (V)
BC328	PNP TO - 92	Ampl. finale BF compl. BC338	Dati tecnici come BC327 eccetto: VCES : 30 V VCEO : 25 V			
BC337	NPN TO - 92	Ampl. finale BF compl. BC327	VCES : 50 V VCEO : 45 V IC : 0,5 A	P : 0,5 W Tj : 150 °C Rthc : 170 °C/W	hFE : 100 - 600 fT : 200 MHz	100 10 5
BC338	NPN TO - 92	Ampl. finale BF compl. BC328	Dati tecnici come BC337 eccetto: VCES : 30 V VCEO : 25 V			
BC370	PNP TO - 18	Ampl. pilota BF Commutazione	VCEO : 20 V VCBO : 20 V IC : 0,5 A	P : 0,375 W Tj : 175 °C	hFE : 50 - 500 fT : 150 MHz	10 5
BC377	NPN TO - 18	Ampl. pilota BF Commutazione	VCEO : 45 V VCBO : 50 V IC : 1 A	VCBO : 50 V Tj : 175 °C	hFE : 75 - 500 fT : 200 MHz	100 1
BC378	NPN TO - 18	Ampl. pilota BF Commutazione	VCEO : 25 V VCBO : 30 V IC : 1 A	P : 0,375 W Tj : 175 °C	hFE : 75 - 500 fT : 200 MHz	100 1
BC395	NPN TO - 39	Ampl. pilota Deflessione vert. TV	VCEO : 70 V VCBO : 80 V	P : 0,3 W		
BC396	PNP TO - 39	Ampl. finale vert. TV	Dati tecnici come BC393			
BC404	PNP TO - 92	Ampl. alta tensione	VCEO : 80 V VCBO : 80 V IC : 0,15 A	P : 0,36 W	hFE : 160	2
BC405	PNP TO - 92	Preampl. BF basso rumore	VCBO : 60 V IC : 0,15 A	P : 0,36 W	hFE : 195	
BC406	PNP TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	VCBO : 40 V IC : 0,15 A	P : 0,36 W	hFE : 290	
BC440	NPN TO - 39	Ampl. BF media potenza Commutazione	VCEO : 40 V VCBO : 50 V IC : 2 A	P : 10 W Tc : 25 °C Tj : 200 °C	hFE : 40 - 250 fT : >50 MHz	500 4
BC441	NPN TO - 39		Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: VCEO : 60 V VCBO : 75 V			
BC460	PNP TO - 39		Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: VCEO : 40 V VCBO : 50 V			
BC461	PNP TO - 39		Impiego e dati tecnici come BC440 eccetto: VCEO : 60 V VCBO : 75 V			

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ C$)	CARATTERISTICHE a	I_C (mA)	V_{CE} (V)	f (MHz)	
BC507	NPN TO - 92	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 70\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$	$h_{FE} : 230$		2	
BC508	NPN TO - 92	Preampl. BF basso rumore	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$	$h_{FE} : 350$		2	
BC509	NPN TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	$V_{CEO} : 60\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$	$h_{FE} : 195$			
BC510	NPN TO - 92	Preampl. BF bassissimo rumore	$V_{CEO} : 40\text{ V}$ $I_C : 0,2\text{ A}$	$P : 0,36\text{ W}$	$h_{FE} : 195$			
BD109	NPN di potenza Commutazione	Ampl. BF	$V_{CEO} : 40\text{ V}$	$P : 18,5\text{ W}$	B	$h_{FE} : 30\text{ - }90$	1000 2	
			$V_{CBO} : 60\text{ V}$	$T_c : 45^\circ C$	C	$h_{FE} : 50\text{ - }150$	1000 2	
			$I_C : 3\text{ A}$	$T_j : 175^\circ C$	D	$h_{FE} : 100\text{ - }300$	1000 2	
SOT-9				$R_{thc} : 7^\circ C/W$		$\beta : 30\text{ - }300$	1000 2	
BD111	NPN vert. TV TO - 3A	Ampl. finale	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 15\text{ W}$	$h_{FE} : 100$	500	10	
			$V_{CBO} : 80\text{ V}$	$T_c : 75^\circ C$	$\beta : 5$	500	5	
			$I_C : 10\text{ A}$ (impulso di 10 μs)	$T_j : 150^\circ C$	$R_{thc} : 5^\circ C/W$		20	
BD115	NPN pilota stadi Deflessione TV	Ampl. BF e video TV	$V_{CEO} : 180\text{ V}$	$P : 6\text{ W}$	$h_{FE} : 60$	50	100	
			$V_{CBO} : 245\text{ V}$	$T_a : 50^\circ C$ con diss. alluminio	$f_T : 145\text{ MHz}$	30	100	
			$I_C : 0,15\text{ A}$	30 cm ² , spessore 1,5 mm				
TO - 39				$T_j : 200^\circ C$	$R_{thc} : 200^\circ C/W$			
				$R_{thc} : 12,5^\circ C/W$				
BD116	NPN TO - 3A	Ampl. finale BF	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 20\text{ W}$	$h_{FE} : 120$	200	10	
			$V_{CBO} : 80\text{ V}$	$T_c : 50^\circ C$	$\beta : 2,3$	200	10	
			$I_C : 3\text{ A}$	$T_j : 150^\circ C$	$R_{thc} : 5^\circ C/W$		20	
BD117	NPN TO - 3A	Ampl. BF di potenza	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 30\text{ W}$	$h_{FE} : 70$	50	5	
			$V_{CBO} : 100\text{ V}$	$T_c : 25^\circ C$				
				$T_j : 150^\circ C$	$R_{thc} : 3,33^\circ C/W$			
BD118	NPN TO - 3A	Regolatore di tensione	$V_{CEO} : 60\text{ V}$	$P : 20\text{ W}$	$h_{FE} : 90$	100	5	
			$V_{CBO} : 80\text{ V}$	$T_c : 50^\circ C$	$\beta : > 1,5$	200	10	
				$T_j : 150^\circ C$	$R_{thc} : 5^\circ C/W$		20	
BD124	NPN SOT - 9	Finale BF	$V_{CEO} : 45\text{ V}$	$P : 15\text{ W}$	$h_{FE} : 60$	50	5	
			$V_{CBO} : 70\text{ V}$	$T_c : 62,5^\circ C$	$f_T : 120\text{ MHz}$	250	5	
			$I_C : 2\text{ A}$	$T_j : 175^\circ C$	$R_{thc} : 7,5^\circ C/W$			
BD127	NPN SOT - 9	Finale vert. TV	$V_{CEO} : 300\text{ V}$	$P : 16,5\text{ W}$	$h_{FE} : 70$	50	20	
			$V_{CBO} : 350\text{ V}$	$T_c : 25^\circ C$	$f_T : 20\text{ MHz}$	50	20	
			$I_C : 0,15\text{ A}$	$T_j : 175^\circ C$				

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a	Ic (mA)	Vce (V)
BD128	NPN SOT-9	Impiego generale di potenza e alta tensione	Dati tecnici come BD127 eccetto: VCEO : 360 V VCBO : 400 V	hFE : 50	50	20	
BD129	NPN SOT-9		Impiego e dati tecnici come BD128 eccetto: VCBO : 350 V	hFE : >10 MHz	50	20	
BD135	NPN compl. BD136	Pilota BF TO-126	VCEO : 45 V VCBO : 45 V IC : 0,5 A Rthc : 10 °C/W	P : 6,5 W Tc : 60 °C Tj : 125 °C fT : 250 MHz	6 hFE : 40 - 100 10 hFE : 63 - 160 16 hFE : 100 - 250	150 150 150	2 2 2
BD136	PNP TO-126	Pilota BF compl. BD135	Dati tecnici come BD135 eccetto:	fT : 75 MHz	50	5	
BD137	NPN compl. BD138	Pilota BF TO-126	VCEO : 60 V VCBO : 60 V IC : 0,5 A Rthc : 10 °C/W	P : 6,5 W Tc : 60 °C Tj : 125 °C fT : 250 MHz	6 hFE : 40 - 100 10 hFE : 63 - 160 fT : 250 MHz	150 150 50	2 2 5
BD138	PNP TO-126	Pilota BF compl. BD137	Dati tecnici come BD137 eccetto:	fT : 75 MHz	50	5	
BD139	NPN TO-126	Pilota BF compl. BD140	Dati tecnici come BD137 eccetto: VCEO : 80 V VCBO : 80 V				
BD140	PNP TO-126	Pilota BF compl. BD139	Dati tecnici come BD137 eccetto: VCEO : 80 V VCBO : 80 V	fT : 75 MHz	50	5	
BD141	NPN TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO : 120 V VCBO : 140 V IC : 8 A	P : 117 W Tc : 25 °C Tj : 200 °C	hFE : 20 - 70	2000	4
BD142	NPN TO-3	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO : 40 V VCBO : 50 V IC : 15 A	P : 117 W Tc : 26 °C Tj : 200 °C	hFE : 12,5 - 160 fT : 1,3 MHz	4000	4
BD144	NPN TO-3	Circuiti defless. vert. TV	Vcer : 400 V (RBE : <500 Ω) VCBO : 400 V IC : 0,25 A	P : 8 W Tc : 95 °C Tj : 135 °C Rthc : 5 °C/W	hFE : >20 fT : 12 MHz	200 50	20 5
BD145	NPN TO-3	Circuiti defless. orizz. TV	VCEO : 60 V VCBO : 60 V IC : 6 A	P : 15 W Tc : 100 °C Tj : 175 °C Rthc : 5 °C/W	hFE : >45 fT : 100 MHz	500 500	10 5
BD162	NPN SOT-9	Ampl. finale BF Commutazione	VCEO : 20 V VCBO : 40 V IC : 4 A	P : 23 W Tc : 60 °C Tj : 200 °C	hFE : 40 - 180 fT : >0,8 MHz	500	2

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a	Ic (mA)	Vce (V)	f (MHz)
BD163	NPN SOT-9			Impiego e dati tecnici come BD162 eccetto: VCEO : 40 V VCBO : 60 V				
BD191	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEO : 60 V VCBO : 100 V IC : 15 A	P : 37,5 W Tc : 25 °C Tj : 175 °C	hFE : 20 - 70 fT : >0,8 MHz	4000	4	
BD192	NPN SOT-9			Impiego e dati tecnici come BD191 eccetto: VCEO : 40 V VCBO : 50 V				
BD193	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEO : 120 V VCBO : 140 V IC : 8 A	P : 37,5 W Tc : 25 °C Tj : 175 °C	hFE : 20 - 70	2000	4	
BD215	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEO : 300 V VCBO : 500 V IC : 0,5 A	P : 21,5 W Tc : 25 °C Tj : 175 °C	hFE : >40 fT : 10 MHz	100	10	
BD216	NPN SOT-9	Ampl. BF di potenza Commutazione	VCEO : 200 V VCBO : 300 V IC : 1 A	P : 21,5 W Tc : 25 °C Tj : 175 °C	hFE : 40 - 150 fT : 10 MHz	100	10	
BF109	NPN TO-5	Ampl. finale video TV Commutazione	VCEO : 110 V VCBO : 135 V IC : 50 mA	P : 0,6 W Tc : 100 °C Tj : 175 °C	hFE : >20 fT : 135 MHz	10	10	
BF110	NPN TO-39	Ampl. finale video TV	Vces : 160 V IC : 40 mA	P : 2,5 W Tc : 25 °C Tj : 200 °C Rthc : 250 °C/W	hFE : >30 fT : 150 MHz	10	10	
BF111	NPN TO-39	Ampl. video per TV color	VCer : 200 V (RBE : <1 kΩ) IC : 80 mA	P : 3 W Tc : 100 °C Tj : 175 °C Rthc : 200 °C/W	hFE : >20 fT : 120 MHz	60	20	
BF114	NPN TO-5	Ampl. finale video TV	VCEO : 130 V VCBO : 160 V IC : 50 mA	P : 0,59 W Tc : 45 °C Tj : 175 °C Rthc : 60 °C/W	hFE : >30 fT : >80 MHz	10	10	
BF115	NPN TO-72R	Ampl. RF AM-FM Ampl. BF basso rumore	VCEO : 30 V VCBO : 50 V IC : 30 mA	P : 0,145 W Ta : 45 °C Tj : 175 °C	hFE : 47 - 165 Yfe : 30 mS fT : 230 MHz fβ : 1 MHz	1	10	100
BF117	NPN TO-5 TO-39	Ampl. finale video TV	VCEO : 140 V	P : 1,2 W	hFE : >25 fT : 100 MHz		30	
BF152	NPN TO-106	Oscill. conv. TV-FM	VCEO : 12 V VCBO : 30 V	P : 0,2 W Tj : 125 °C Rthc : 200 °C/W	hFE : 50 β : 8 fT : 600 MHz	3	10	1

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF153	NPN	Ampl. FI-AM	V _{CEO} : 12 V V _{CBO} : 30 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 50 β : 4 G _{tr} : 44 dB f _T : 400 MHz	3 6	100 0,47
BF154	NPN	Ampl. pilota video TV	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 30 V TO - 106	P : 0,3 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 125 °C/W	h _{FE} : 50 β : 4 f _T : 400 MHz	10 10	2 10 100
BF155	NPN	Oscill. conv. UHF	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V IC : 20 mA TO - 72	P : 175 mW T _j : 175 °C R _{rhc} : 580 °C/W	h _{FE} : 70 β : 6 f _T : 400 MHz	2,5 12	12 100
BF156	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 120 V V _{CBO} : 120 V TO - 5	P : 0,8 W			
BF157	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 150 V V _{CBO} : 150 V TO - 5	P : 0,8 W			
BF158	NPN	Ampl. FI-TV	V _{CEO} : 12 V V _{CBO} : 30 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 50 β : 8 G _{tr} : 26 dB f _T : 600 MHz	4 10	5 10 100 40
BF159	NPN	Ampl. FI-TV	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 40 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 50 β : 8 G _{tr} : 26 dB f _T : 600 MHz	4 10	5 10 100 40
BF160	NPN	Ampl. FI per AM-FM	V _{CEO} : 12 V V _{CBO} : 30 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 50 β : 6 G _{tr} : 32 dB f _T : 400 MHz	3 10	100 0,7
BF161	NPN	Oscill. conv. UHF	V _{CEO} : 50 V V _{CBO} : 50 V IC : 20 mA TO - 72	P : 175 mW T _j : 175 °C R _{rhc} : 580 °C/W	h _{FE} : 60 β : 5,5 GUM : 12 dB f _T : 350 MHz	3 10	100 800
BF162	NPN	Ampl. RF-FI e oscill.	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 70 f _T : 400 MHz	4	
BF163	NPN	Ampl. FI per TV AGC	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V TO - 106	P : 0,2 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 70 β : 6 GUM : 30 dB f _T : 400 MHz	4 10	100 40
BF166	NPN	Impiego generale RF	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V TO - 72	P : 175 mW T _j : 175 °C R _{rhc} : 580 °C/W	h _{FE} : 50 β : 5 GUM : 18 dB f _T : 300 MHz	2,5 12	100 200
BF167	NPN	Ampl. RF-FI per TV studio controllato	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 40 V IC : 25 mA TO - 72R	P : 0,13 W T _a : 45 °C T _j : 175 °C R _{rhc} : 650 °C/W	h _{FE} : 57 Y _{fe} : 105 mS GUM : 42 dB f _T : 350 MHz	4 10	35 35

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF169	NPN	Preampl. video TV	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 50 V TO - 18	P : 0,3 W T _j : 175 °C I _C : 50 mA	β : 200-500 f _T : 250 MHz	2 5	
BF169R	NPN	RO - 110		Impiego e dati tecnici come BF169 eccetto: T _j : 125 °C			
BF169A	NPN	Preampl. video TV	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 30 V TO - 72R	P : 175 mW T _j : 175 °C I _C : 30 mA	h _{FE} : 90-330 f _T : 250 MHz	1 10	
BF169RA	NPN	Preampl. video TV	V _{CEO} : 30 V V _{CBO} : 30 V RO - 110R	P : 0,3 W T _j : 125 °C I _C : 30 mA	h _{FE} : >90 f _T : 250 MHz	1 10	
BF173	NPN	Ampl. uscita FI video TV	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 40 V TO - 72R	P : 0,26 W T _a : 45 °C I _C : 25 mA	h _{FE} : 88 Y _{fe} : 145 mS alletta n. 2 T _j : 175 °C R _{rha} : 0,65 °C	7 10	35
BF174	NPN	Ampl. finale video	V _{CEO} : 150 V V _{CBO} : 150 V TO - 39	P : 0,8 W T _j : 200 °C I _C : 0,1 A	h _{FE} : 70 β : 4	10 50	20
BF175	NPN	Ampl. FI per TV AGC	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V TO - 72	P : 175 mW T _j : 175 °C R _{rhc} : 583 °C/W	h _{FE} : 70 β : 5 GUM : 30 dB	2,5 12	100 40
BF176	NPN	Ampl. FI per TV	V _{CEO} : 40 V V _{CBO} : 40 V TO - 105	P : 0,25 W T _j : 125 °C R _{rhc} : 200 °C/W	h _{FE} : 65 β : 4,5 GUM : 30 dB	10 10	100 36
BF177	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 60 V V _{CBO} : 100 V TO - 5 TO - 39	P : 0,6 W T _a : 65 °C I _C : 50 mA	h _{FE} : >20 f _T : 120 MHz	15 10	
BF178	NPN	TO - 5	V _{CEO} : 110 V V _{CBO} : 160 V TO - 39	Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: V _{CEO} : 110 V V _{CBO} : 160 V			
BF178T	NPN	TO - 5		Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: P : 0,5 W T _a : 65 °C R _{rhc} : 75 °C/W			
BF179	NPN	TO - 5	V _{CEO} : 115 V V _{CBO} : 250 V TO - 39	Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: V _{CEO} : 115 V V _{CBO} : 250 V			
BF179A	NPN	TO - 5	V _{CEO} : 115 V V _{CBO} : 160 V TO - 39	Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto: V _{CEO} : 115 V V _{CBO} : 160 V I _C : 50 mA	h _{FE} : >20 f _T : 120 MHz	20 15	
BF179B	NPN	Ampl. finale video TV colore	V _{CEO} : 115 V V _{CBO} : 160 V TO - 5 TO - 39	P : 1,7 W T _c : 125 °C I _C : 50 mA	h _{FE} : >20 f _T : 120 MHz	10 10	

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)	I _c (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF179B	NPN TO-5 TO-39		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto: V _{CBO} : 220 V				
BF179C	NPN TO-5 TO-39		Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto: V _{CBO} : 250 V P : 0,6 W				
BF180	NPN Ampl. RF UHF - VHF TO-72	V _{CEO} : 20 V P : 150 mW V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA		h _{FE} : 45 GUM : 12 dB f _T : 675 MHz	2 10	900	
BF181	NPN Oscill. conv. UHF TO-72	Dati tecnici come BF180 eccetto: V _{CEO} : 20 V P : 150 mW V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA		h _{FE} : 29 GUM : 11 dB f _T : 600 MHz	2 10	900	
BF182	NPN Oscill. conv. VHF - UHF TO-72	V _{CEO} : 20 V P : 150 mW V _{CBO} : 25 V T _j : 175 °C I _c : 15 mA		h _{FE} : 20 dB Y _{fb} : 18 mS GUM : 11 dB f _T : 650 MHz	2 10	900	
BF183	NPN TO-72	Impiego e dati tecnici come BF182 eccetto: V _{CEO} : 20 V P : 150 mW V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA		h _{FE} : 25 GUM : 13 dB f _T : 800 MHz	3 10	900	
BF184	NPN Ampl. RF - FI per AM - FM TO-72R	V _{CEO} : 20 V P : 145 mW V _{CBO} : 30 V T _a : 45 °C I _c : 30 mA T _j : 175 °C		h _{FE} : 75-750 Y _{fe} : 36 mS f _T : 300 MHz	1 10	100	
BF185	NPN TO-72R	Impiego e dati tecnici come BF184 eccetto: V _{CEO} : 20 V P : 145 mW V _{CBO} : 30 V T _a : 45 °C I _c : 30 mA T _j : 175 °C		h _{FE} : 34 - 140 Y _{fe} : 33 mS f _T : 220 MHz	1 10	100	
BF186	NPN Ampl. finale di illuminanza TO-39	V _{CER} : 190 V P : 2,75 W (R _{BE} : < 1 kΩ) T _c : 145 °C V _{CBO} : 190 V T _j : 200 °C I _c : 60 mA R _{tha} : 200 °C/W		h _{FE} : > 20 f _T : 120 MHz	40 20	10 10	
BF194	NPN Ampl. RF - FI MM-12R oscill. per AM - FM SOT-25R	V _{CEO} : 20 V P : 0,22 W V _{CBO} : 30 V T _j : 125 °C I _c : 30 mA		h _{FE} : 115 Y _{fe} : 35 mS f _T : 260 MHz	1 10	35	
BF195	NPN MM-12R SOT-25R	Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto: V _{CEO} : 20 V P : 0,22 W V _{CBO} : 30 V T _j : 125 °C I _c : 30 mA		h _{FE} : 67 Y _{fe} : 31 mS f _T : 200 MHz	1 10	100	
BF196	NPN Ampl. FI - TV CAG MM-12R SOT-25R	V _{CEO} : 30 V P : 0,25 W V _{CBO} : 40 V T _j : 125 °C I _c : 25 mA		h _{FE} : > 20 Y _{fe} : 100 mS GUM : 39 dB f _T : 400 MHz	6 2	40 10 45	
BF197	NPN Ampl. uscita FI video TV MM-12R SOT-25R	V _{CEO} : 25 V P : 0,25 W V _{CBO} : 40 V T _j : 125 °C I _c : 25 mA		h _{FE} : > 38 Y _{fe} : 155 mS GUM : 41 dB f _T : 550 MHz	7 10	45	

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a (T _a = 25 °C)	I _c (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF198	NPN TO-92R MM-11R		Impiego e dati tecnici come BF196				
BF199	NPN TO-92R MM-11R		Impiego e dati tecnici come BF197				
BF200	NPN Ampl. VHF TO-72	V _{CEO} : 20 V P : 0,15 W V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA		h _{FE} : 30 Y _{fe} : 56 mS GUM : 22 dB f _T : 650 MHz	3 10	100	
BF206	NPN Oscill. conv. UHF TO-72	V _{CEO} : 20 V P : 0,2 W V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA R _{thc} : 400 °C/W		h _{FE} : 70 G _p : 20 dB f _T : 500 MHz	2 10	200	
BF207	NPN Ampl. FI video TV stadio controllato TO-72R	V _{CEO} : 30 V P : 0,15 W V _{CBO} : 40 V T _j : 175 °C I _c : 25 mA		h _{FE} : 80 Y _{fe} : 95 mS GUM : 42 dB f _T : 400 MHz	4 10	36,6	
BF207R	NPN RO-110R		Impiego e dati tecnici come BF207 eccetto: P : 0,3 W				
BF208	NPN Ampl. FI video TV TO-72R	V _{CEO} : 25 V P : 0,23 W V _{CBO} : 40 V T _j : 175 °C I _c : 25 mA		h _{FE} : 100 Y _{fe} : 145 mS GUM : 43 dB f _T : 600 MHz	7 10	36,6	
BF208R	NPN RO-110R		Impiego e dati tecnici come BF208 eccetto: P : 0,3 W				
BF212	NPN Ampl. RF per UHF TO-72	V _{CEO} : 20 V P : 0,2 W V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA		h _{FE} : 80 f _T : 600 MHz	2 10		
BF213	NPN Conv. UHF TO-72	Dati tecnici come BF212 eccetto:		h _{FE} : 50 f _T : 550 MHz	2 10		
BF214	NPN Oscili. conv. per OM - OC Ampl. FI TO-72R per AM - FM	V _{CEO} : 30 V P : 165 mW V _{CBO} : 30 V T _j : 175 °C I _c : 30 mA R _{thc} : 500 °C/W		h _{FE} : 90-330 Y _{fe} : 35 mS f _T : 250 MHz	1 10	10,7	
BF215	NPN Preampl. RF oscill. conv. per FM TO-72R		Dati tecnici come BF214 eccetto:	h _{FE} : 40 - 165 Y _{fb} : 33 mS	1 10	100	
BF222	NPN Ampl. RF conv. FM TO-72	V _{CEO} : 50 V P : 175 mW V _{CBO} : 50 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA R _{thc} : 577 °C/W		h _{FE} : 60 β : 4 GUM : 20 dB	2 7	100	
BF223	NPN Ampl. FI SOT-25R per TV colore MM-12R	V _{CEO} : 25 V P : 0,35 W V _{CBO} : 35 V T _j : 140 °C I _c : 40 mA R _{thc} : 230 °C/W		h _{FE} : > 40 Y _{fe} : 200 mS f _T : 750 MHz	5 10	36	

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a	I _c (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF227	NPN	Ampl. FI video TV	V _{CEO} : 25 V P : 50 mW V _{CBO} : 40 V T _a : 45 °C I _c : 25 mA T _j : 125 °C	h _{FE} : 100 Y _{fe} : 80 mS f _T : 600 MHz	3 3 3	10 10 10	36
BF228	NPN	Ampl. pilota per nixie	V _{CEO} : 80 V P : 50 mW V _{CBO} : 7 V T _a : 45 °C I _c : 50 mA T _j : 125 °C	h _{FE} : >30 f _T : >50	2 10	10	10
BF229	NPN		Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto: P : 50 mW T _a : 45 °C				
BF230	NPN		Impiego e dati tecnici come BF195 eccetto: P : 50 mW T _a : 45 °C				
BF232	NPN	Ampl. FI video TV	V _{CEO} : 25 V P : 0,23 W V _{CBO} : 48 V T _j : 175 °C I _c : 30 mA R _{rhc} : 350 °C/W	h _{FE} : >30 f _T : 600 MHz	7 10	10	
BF233	NPN	Oscill. conv. per OM - OC Ampl. FI per AM - FM	V _{CEO} : 30 V P : 0,3 W V _{CBO} : 30 V T _j : 125 °C I _c : 30 mA	2 h _{FE} : 40 - 70 3 h _{FE} : 60 - 100 4 h _{FE} : 90 - 150 5 h _{FE} : 140 - 220 6 h _{FE} : 200 - 350 Y _{fe} : 33 mS f _T : 250 MHz	1 1 1 1 1 1	10 10 10 10 10 10,7	
BF234	NPN	RO - 110R	Impiego e dati tecnici come BF233 eccetto:	h _{FE} : 90 - 330	1	10	
BF235	NPN	Preampl. RF RO - 110R oscill. conv. FM	Dati tecnici come BF233 eccetto :	h _{FE} : 40 - 165	1	10	
BF240	NPN	Ampl. RF per AM - FM	V _{CEO} : 40 V P : 225 mW V _{CBO} : 40 V T _j : 125 °C I _c : 25 mA	h _{FE} : 67 - 220 Y _{fe} : 75 mS f _T : 430 MHz	2 10 10	10,7	
BF241	NPN	Ampl. RF per AM e MM - 11R FM - AGC	V _{CEO} : 40 V P : 225 mW V _{CBO} : 40 V T _j : 125 °C I _c : 25 mA	h _{FE} : 36 - 125 Y _{fe} : 75 mS f _T : 400 MHz	2 10 10	10,7	
BF254	NPN	TO - 92R MM - 11R	Impiego e dati tecnici come BF194				
BF255	NPN	TO - 92R MM - 11R	Impiego e dati tecnici come BF195				
BF257	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 160 V P : 5 W I _c : 0,1 A T _c : 25 °C TO - 39 T _j : 125 °C	h _{FE} : >25 f _T : 110 MHz	30 30	10	

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE a	I _c (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BF258	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 250 V P : 5 W I _c : 0,1 A T _c : 25 °C TO - 39 T _j : 125 °C	h _{FE} : >25 f _T : 110 MHz	30 30	10	
BF259	NPN	Ampl. finale video TV	V _{CEO} : 300 V P : 5 W I _c : 0,1 A T _c : 25 °C TO - 39 T _j : 125 °C	h _{FE} : >25 f _T : 110 MHz	30 30	10	
BF260	NPN	Preampl. VHF TO - 72R CAG	V _{CBO} : 45 V P : 0,15 W I _c : 50 mA T _j : 175 °C	h _{FE} : 70 f _T : 800 MHz	1 1	6	
BF261	NPN	Ampl. FI TO - 72R CAG	Dati tecnici come BF260 eccetto: V _{CBO} : 40 V				f _T : 730 MHz
BF270	NPN	Ampl. FI per TV stadio controllato	V _{CEO} : 40 V P : 0,150 W V _{CBO} : 40 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA R _{rhc} : 750 °C/W	h _{FE} : 45 β : 6	3,5 3,5	10 10	100
BF271	NPN	Ampl. FI - TV TO - 72R	V _{CEO} : 40 V P : 0,24 W V _{CBO} : 40 V T _j : 175 °C I _c : 30 mA R _{rhc} : 375 °C/W	h _{FE} : 75 β : 10	10 10	15 15	100
BF287	NPN	Oscill. conv. per AM Ampl. FI TO - 72R per AM - FM	V _{CEO} : 40 V P : 0,150 W V _{CBO} : 40 V T _j : 175 °C I _c : 20 mA R _{rhc} : 750 °C/W	h _{FE} : 50 β : 6	1 1	7 7	100
BF288	NPN	Ampl. FI per AM - FM stadio controllato	Dati tecnici come BF287 eccetto: TO - 72R	h _{FE} : 90 β : 5	1 1	7 7	100
BF290	NPN	Oscill. conv. UHF TO - 72R	Dati tecnici come BF287 eccetto: TO - 18	h _{FE} : 60 β : 9	3 3	10 10	100
BF291	NPN	Pilota video Elaboratore di segnali di colore	V _{CEO} : 40 V P : 0,36 W V _{CBO} : 50 V T _j : 200 °C I _c : 0,1 A R _{rhc} : 146 °C/W	A h _{FE} : 105 B h _{FE} : 170 β : 3,8 t _{on} : 28 ns t _{off} : 237 ns	2 2 10 10	10 10	100
BF292A	NPN	Uscita video alta tensione TO - 5 TO - 39	V _{CEO} : 150 V P : 0,8 W V _{CBO} : 150 V T _j : 200 °C I _c : 0,1 A R _{rhc} : 35 °C/W	h _{FE} : 70 β : 3,3	10 10	50 50	50
BF292B	NPN		Impiego e dati tecnici come BF292A eccetto: TO - 5 TO - 39	V _{CEO} : 190 V V _{CBO} : 190 V			
BF292C	NPN		Impiego e dati tecnici come BF292A eccetto: TO - 5 TO - 39	V _{CEO} : 220 V V _{CBO} : 220 V			
BF302	NPN	Ampl. FI per AM - FM TO - 72R	V _{CBO} : 40 V P : 0,15 W I _c : 50 mA T _j : 175 °C	h _{FE} : 35 - 125 f _T : 650	1 1	6	

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE a			Ic (mA)	Vce (V)	f (MHz)
			VCEO	P	Tj	hFE	1	6			
BF303	NPN TO-72R	Ampl. FI per AM	VCEO : 40 V Ic : 50 mA	P : 0,15 W Tj : 175 °C		hFE : 110 - 220 fT : 500 MHz	1	6			
BF304	NPN TO-72R	Ampl. RF per VHF	VCEO : 40 V Ic : 50 mA	P : 0,15 W Tj : 175 °C		hFE : 35 - 120 fT : 500 MHz	1	6			
BF305	NPN TO-39	Ampl. finale video TV	VCEO : 185 V Ic : 0,1 A	P : 0,6 W Ta : 65 °C Tj : 200 °C		hFE : 20 fT : 100 MHz					
BF306	NPN TO-72R	Amp. FI video TV	VCEO : 25 V VCEO : 40 V Ic : 25 mA	P : 0,175 mW Tj : 175 °C		hFE : 37 fT : 1000 MHz	7	10			
BF310	NPN TO-92	Ampl. FI - TV	VCEO : 30 V Ic : 25 mA	P : 0,24 W Ta : 45 °C		hFE : >28 Yfe : >80 mS fT : <580 MHz	4				
BF311	NPN TO-92R	Ampl. FI - TV	VCEO : 25 V Ic : 40 mA	P : 0,28 W Ta : 45 °C		hFE : >40 Yfe : >155 mS fT : 750 MHz	15				
BF314	NPN TO-92	Ampl. conv. per VHF	VCEO : 30 V Ic : 25 mA	P : 0,24 W Ta : 45 °C		hFE : >28 Yfe : 36 mS fT : <580 MHz	4 10				
BF329	NPN SOT-25R		Impiego e dati tecnici come BF196								
BF330	NPN SOT-25R		Impiego e dati tecnici come BF197								
BF332	NPN SOT-25R	Conv. oscill. AM	VCEO : 30 V Ic : 30 mA	P : 0,25 W Tj : 125 °C		hFE : 65 - 220 fT : 600 MHz	1	10			
BF333	NPN SOT-25R	Ampl. FI	Dati tecnici come BF332 eccetto:			hFE : 35 - 120 fT : 400 MHz	1	10			
BF334	NPN SOT-25R	Ampl. FI per AM - FM	VCEO : 30 V VCEO : 40 V Ic : 25 mA	P : 0,25 W Tj : 125 °C		hFE : 65 - 220 Yfe : 36 mS fT : 430 MHz	1 10	10,7			
BF335	NPN SOT-25R		Impiego e dati tecnici come BF334 eccetto:			hFE : 35 - 125 fT : 370 MHz	1	10			
BF336	NPN TO-39	Ampl. finale video TV	VCEO : 180 V VCEO : 185 V Ic : 0,1 A	P : 3 W Tc : 140 °C Tj : 200 °C Rthc : 220 °C/W		hFE : >20 fT : >80 MHz	30	10			
BF337	NPN TO-39		Impiego e dati tecnici come BF336 eccetto: VCEO : 200 V VCBO : 250 V								

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)			CARATTERISTICHE a			Ic (mA)	Vce (V)
			VCEO	P	Tj	hFE	1	10		
BF338	NPN TO-39		Impiego e dati tecnici come BF336 eccetto: VCEO : 225 V VCBO : 300 V							
BF344	NPN TO-18R	Ampl. RF - FI	VCEO : 30 V VCBO : 30 V Ic : 50 mA	P : 0,15 W Tj : 175 °C		hFE : 90 - 220 fT : 500 MHz	1	10		
BF345	NPN TO-18R		Impiego e dati tecnici come BF344 eccetto:			hFE : 40 - 115	1	10		
BF390	NPN TO-39	Ampl. uscita TV colore	VCEO : 310 V Ic : 0,1 A	P : 0,6 W Ta : 65 °C Tj : 175 °C		hFE : 20 fT : 120 MHz				
BFY37	NPN TO-18	Ampl. RF Oscill. VHF	VCEO : 20 V VCBO : 25 V Ic : 0,1 A	P : 0,3 W Tj : 175 °C Rthc : 150 °C/W		hFE : >35 fT : >200 MHz	10	10		
BFY39	NPN TO-18	Ampl. RF Oscill. VHF	VCEO : 25 V VCBO : 45 V Ic : 0,1 A	P : 0,3 W Tj : 175 °C Rthc : 150 °C/W		1 hFE : 35 - 110 2 hFE : 100 - 200 3 hFE : 180 - 400 β : 180 - 400 fT : 150 MHz	10	10		
BFY41	NPN TO-39	Ampl. finale video TV	Vcer : 120 V (Rbe : <250 Ω) VCBO : 120 V Ic : 0,6 A	P : 0,8 W Tj : 200 °C Rthc : 58 °C/W		hFE : >35	50	10		
BFY43	NPN TO-39	Ampl. finale video TV	VCEO : 140 V VCBO : 140 V Ic : 0,1 A	P : 0,8 W Tj : 175 °C		hFE : >25 fT : 60 MHz	10	10		
BFY50	NPN TO-5 TO-39	Impiego generale Commutazione	VCEO : 35 V VCBO : 80 V Ic : 1 A	P : 0,8 W Tj : 200 °C Rthc : 35 °C/W		hFE : 55 β : 45 fT : 100 MHz	150	6		
BFY51	NPN TO-5 TO-39	Impiego generale Commutazione	VCEO : 30 V VCBO : 60 V Ic : 1 A	P : 0,8 W Tj : 200 °C Rthc : 35 °C/W		hFE : 70 β : 60 fT : 110 MHz	50	6		
BFY52	NPN TO-5 TO-39	Impiego generale Commutazione	VCEO : 20 V VCBO : 40 V Ic : 1 A	P : 0,8 W Tj : 200 °C Rthc : 35 °C/W		hFE : 130 β : 120 fT : 120 MHz	150	6		
BSX24	NPN TO-18	Ampl. RF Oscill. VHF Commutazione	VCEO : 32 V VCBO : 32 V Ic : 0,1 A	P : 0,3 W Tj : 175 °C Rthc : 150 °C/W		hFE : >35 fT : 200 MHz ton : 25 ns toff : 400 ns	50	5		
BSY51	NPN TO-39	Oscill. conv. per OM - OC Commutazione	VCEO : 25 V VCBO : 60 V Ic : 0,5 A	P : 0,8 W Tj : 200 °C Rthc : 58 °C/W		hFE : 50 β : 30 - 100 fT : 100 MHz	1	5		

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (Ta = 25 °C)	CARATTERISTICHE (Ta = 25 °C)	a	IC (mA)	Vc (V)
BSY52	NPN	Impiego e dati tecnici come BSY51 eccetto: TO - 39		hFE : 100 β : 50 - 200 f_T : 130 MHz	1	50	10
BU100	NPN	Ampl. finale orizz. TV TO - 3A	VCEO : 60 V VCBO : 150 V IC : 10 A	P : 15 W Tc : 75 °C Tj : 150 °C	hFE : 100	500	10
BU102	NPN	Ampl. finale orizz. TV TO - 3A	VCEO : 150 V VCBO : 400 V IC : 7 A	P : 25 W Tc : 100 °C Tj : 150 °C	hFE : 110 t_{on} : 0,66 μ s t_{off} : 1,1 μ s	1000	5
BU103	NPN	Finale vert. TV TO - 66	VCEP : 120 V (RBE : 220 Ω) VCBO : 120 V	P : 30 W Tc : 25 °C Tj : 175 °C	hFE : 50 - 200 f_T : 100 MHz	200	10
BU104	NPN	Finale orizz. TV TO - 3	VCEX : 400 V VCBO : 400 V IC : 7 A	P : 85 W Tc : 25 °C Tj : 200 °C	hFE : 10 - 50 f_T : 10 MHz	5000	3,5
BU105	NPN	Defless. orizz. TV TO - 3	VCER : 750 V (RBE : \leq 100 Ω) VCBO : 750 V IC : 2,5 A	P : 10 W Tc : 90 °C Tj : 115 °C	hFE : 8 f_T : 7,5 MHz	800	5
BU108	NPN	Defless. orizz. TV colore TO - 3	VCER : 750 V (RBE : \leq 100 Ω) VCBO : 750 V IC : 5 A	P : 12,5 W Tc : 95 °C Tj : 115 °C	hFE : 4 f_T : 7 MHz	4000	5
BU109	NPN	Impiego e dati tecnici come BU104 eccetto: TO - 3	VCEX : 330 V VCBO : 330 V			100	5
BU112	NPN	Finale orizz. TV colore TO - 3	VCEX : 550 V VCBO : 550 V IC : 10 A	P : 85 W Tc : 25 °C Tj : 200 °C	hFE : >7	6000	2
BU113	NPN	Impiego e dati tecnici come BU112 eccetto : TO - 3	VCEX : 700 V				
BU115	NPN	Defless. orizz. TV colore TO - 3	VCER : 600 V (RBE : \leq 10 Ω) VCBO : 800 V IC : 15 A	P : 50 W Tc : 75 °C Tj : 150 °C	hFE : 20 - 100	5000	5
BU116	NPN	Commutazione TO - 3	Dati tecnici come BU115 eccetto: VCEP : 300 V VCBO : 400 V				
BU117	NPN	Ampl. pilota orizz. TV colore TO - 3	Dati tecnici come BU115 eccetto: VCER : 200 V VCBO : 250 V				
BU120	NPN	Chopper TV TO - 3	VCEO : 250 V VCBO : 400 V IC : 5 A	P : 50 W Tc : 75 °C Tj : 150 °C	hFE : 35 - 165 f_T : 10 MHz	1000	5

Dati > ~~aggiornato~~

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI ($T_a = 25^\circ C$)	CARATTERISTICHE	a	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
BU121	NPN	Ampl. finale orizz. TV	V _{CEO} : 200 V V _{CBO} : 320 V I _C : 10 A	P : 50 mW T _c : 75 °C T _j : 150 °C	h _{FE} : >7 f _T : 6 MHz	6000	5	
BU122	NPN	Ampl. finale vert. TV	V _{CEO} : 150 V V _{CBO} : 250 V I _C : 5 A	P : 50 W T _c : 75 °C T _j : 150 °C	h _{FE} : 25 - 250 f _T : 10 MHz	1000	5	
BU123	NPN	Ampl. finale BF alta tensione TO-3	V _{CEO} : 120 V. V _{CBO} : 180 V I _C : 5 A	P : 50 W T _c : 75 °C T _j : 160 °C	h _{FE} : 25 - 250 f _T : 10 MHz	1000	5	
BU126	NPN	Defless. orizz. TV	V _{CEO} : 300 V V _{CEX} : 750 V I _C : 3 A	P : 30 W T _c : 50 °C T _j : 125 °C	f _T : 8 MHz	200	10	
BU129	NPN	Ampl. finale orizz. TV	V _{CEX} : 400 V I _C : 5 A	P : 25 W T _c : 100 °C T _j : 150 °C	h _{FE} : >20 f _T : 10 MHz	3000	1,5	
SFT162	PNP	Impieghi generali AF alta tensione	V _{CES} : 70 V V _{CBO} : 70 V I _C : 10 mA	P : 0,15 W T _j : 100 °C R _{thc} : 300 °C/W	β : 50 - 600 f _T : >70 MHz	6	12	
SFT163	PNP	Preampl. video TV	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA	P : 0,15 W T _j : 100 °C R _{thc} : 300 °C/W	β : 200 f _T : 140 MHz	4	9	
SFT211	PNP	Ampl. BF di potenza	V _{CER} : 80 V (R _{BE} : 220 Ω) V _{CBO} : 80 V I _C : 6 A	P : 45 W T _c : 25 °C T _j : 95 °C	h _{FE} : >15 Y h _{FE} : 30 - 70 X h _{FE} : 50 - 100 β : 8 kHz f _T : 0,5 MHz	6000	1 2000	2
SFT213	PNP	Ampl. BF di potenza	V _{CER} : 40 V (R _{BE} : 220 Ω) V _{CBO} : 40 V I _C : 3 A	P : 45 W T _c : 25 °C T _j : 95 °C	h _{FE} : >20 Y h _{FE} : 30 - 70 X h _{FE} : 50 - 100 β : 50 f _β : 8 kHz	3000	2 2000	2
SFT214	PNP	Ampl. BF di potenza Circuiti alim.	V _{CBO} : 60 V I _C : 3 A	P : 45 W T _c : 25 °C T _j : 95 °C	h _{FE} : >15 Z h _{FE} : 20 - 40 Y h _{FE} : 30 - 70 X h _{FE} : 50 - 100 β : 8 kHz f _T : 0,5 MHz	3000	0,5 2000	2
SFT250	PNP	Impiego e dati tecnici come SFT214 eccetto: TO-3						
SFT250	PNP	V _{CBO} : 80 V						
SFT306	PNP	Ampl. FI per AM	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 24 V I _C : 10 mA	P : 0,185 W T _j : 100 °C R _{thc} : 200 °C/W	β : 50 V _{fE} : 17 - 21 mS f _T : 5 MHz	1	6	2
SFT307	PNP	Impiego e dati tecnici come SFT306 eccetto: TO-1			β : 75 bianco V _{fE} : 19 - 24 mS giallo V _{fE} : 22 - 28 mS f _T : 7 MHz	1	6	2

Dati Transistori 2

SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	a	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
SFT308	PNP TO - 1	Ampl. RF conv. oscill. OM	Dati tecnici come SFT306 eccetto: bianco giallo f _T	β : 100 V _{fe} : 26 - 30 mS V _{fe} : > 28 mS	1	6	2	
				β : 100 V _{fe} : 20 mS	1	6	50	
				f _T : 9 MHz	1	6		
SFT316	PNP TO - 72L	Ampl. FI per AM - FM conv. AM	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W	β : 100 blu V _{fe} : 20 mS f _T : 70 MHz	1	6		
				β : 150	1	6		
				V _{fe} : 15 mS f _T : 60 MHz	1	6	50	
SFT317	PNP TO - 1	Conv. AM	Dati tecnici come SFT316 eccetto: verde blu	β : 150 V _{fe} : 70	1	6		
				β : 150	1	6		
				f _T : 60 MHz	1	6		
SFT319	PNP TO - 1	Ampl. FI per AM	Dati tecnici come SFT316 eccetto: verde blu	β : 70 V _{fe} : 20 mS	1	6		
				β : 150	1	6		
				f _T : 60 MHz	1	6		
SFT320	PNP TO - 1	Oscill. conv. per OM - OC	Dati tecnici come SFT316 eccetto: verde blu	β : 150 V _{fe} : 20 mS	1	6		
				β : 150	1	6		
				f _T : 60 MHz	1	6		
SFT321	PNP TO - 1	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	h _{FE} : 20 - 40 oro h _{FE} : 25 arancio h _{FE} : 35 f _β : 17 kHz f _T : 0,8 MHz	100	1		
				h _{FE} : 25	100	1		
				h _{FE} : 35	100	1		
SFT322	PNP TO - 1	Ampl. finale BF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	h _{FE} : 40 - 60 giallo h _{FE} : 45 verde h _{FE} : 55 f _β : 18 kHz f _T : 1,2 MHz	100	1		
				h _{FE} : 45	100	1		
				h _{FE} : 55	100	1		
SFT323	PNP TO - 1	Ampl. finale BF compl. SFT373	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	h _{FE} : 60 - 150 blu h _{FE} : 67 viola h _{FE} : 90 bianco h _{FE} : 115 f _β : 19 kHz f _T : 2,4 MHz	100	1		
				h _{FE} : 67	100	1		
				h _{FE} : 90	100	1		
SFT337	PNP TO - 1	Preampl. BF basso rumore	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 24 V I _C : 0,15 A R _{thc} : 200 °C/W	V β : 50 - 100 VI β : 75 - 150 VII β : 125 - 250 f _β : 40 kHz f _T : 7 MHz	1	6		
				V β : 75 - 150	1	6		
				VII β : 125 - 250	1	6		
SFT337A	PNP TO - 1	Preampl. BF	Dati tecnici come SFT337 eccetto: verde blu viola bianco	β : 45 - 160 β : 55 β : 70 β : 90 β : 130	1	6		
				β : 55	1	6		
				β : 70	1	6		
SFT343	PNP TO - 1	Ampl. BF alta tensione	V _{CES} : 70 V V _{CBO} : 70 V I _C : 0,15 A R _{thc} : 80 °C/W	IV β : > 30 V β : > 50 VI β : > 75 f _β : 18 kHz f _T : 1,2 MHz	1	6		
				β : > 50	1	6		
				β : > 75	1	6		

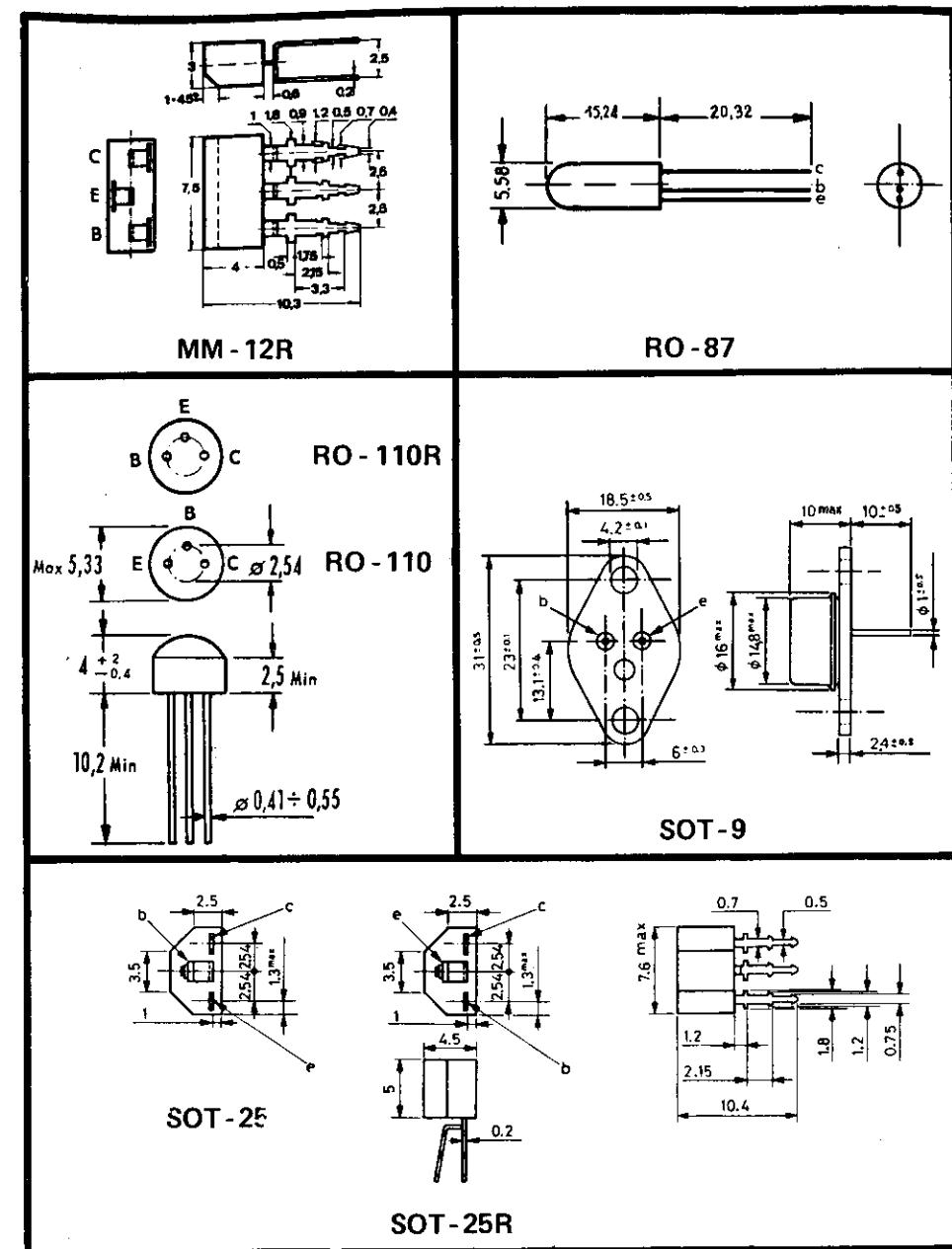
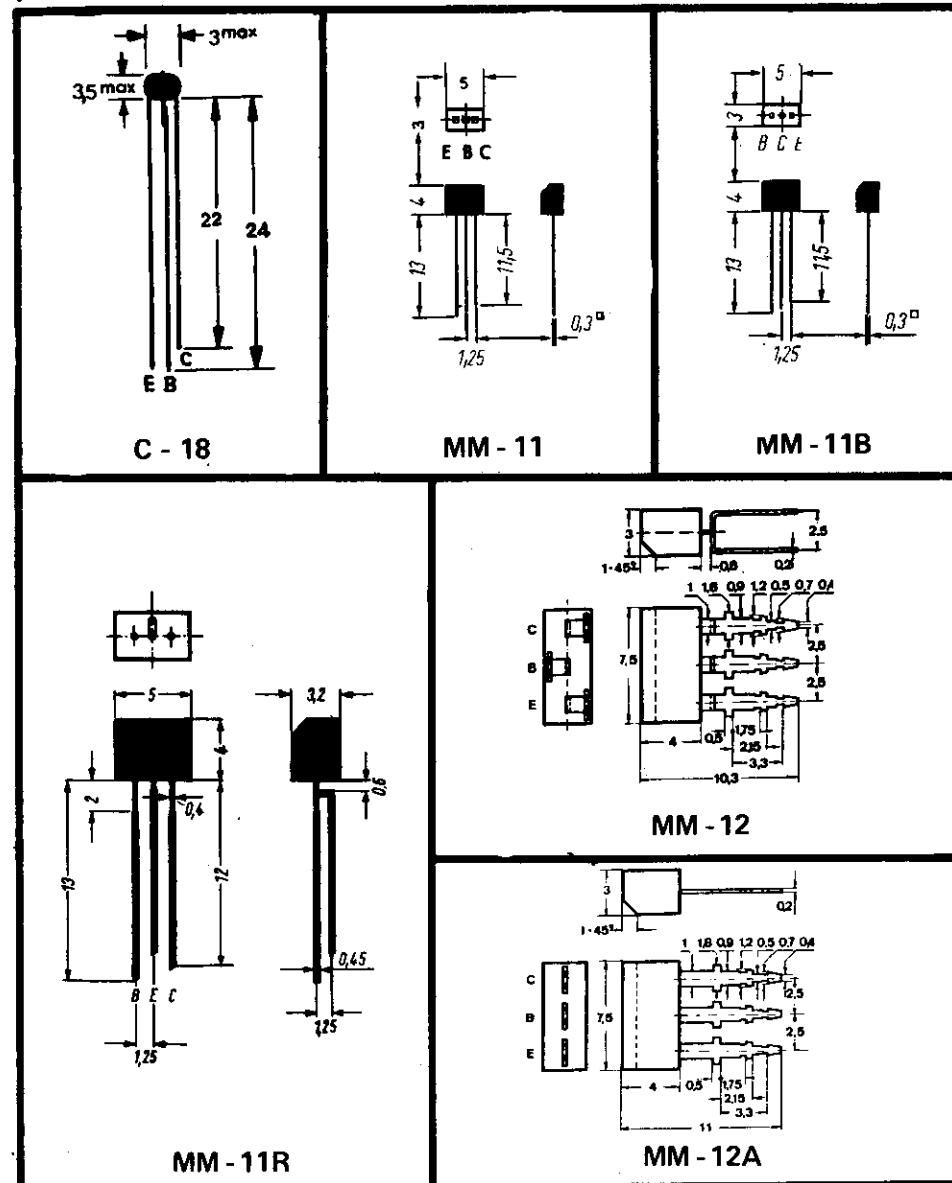
Dati

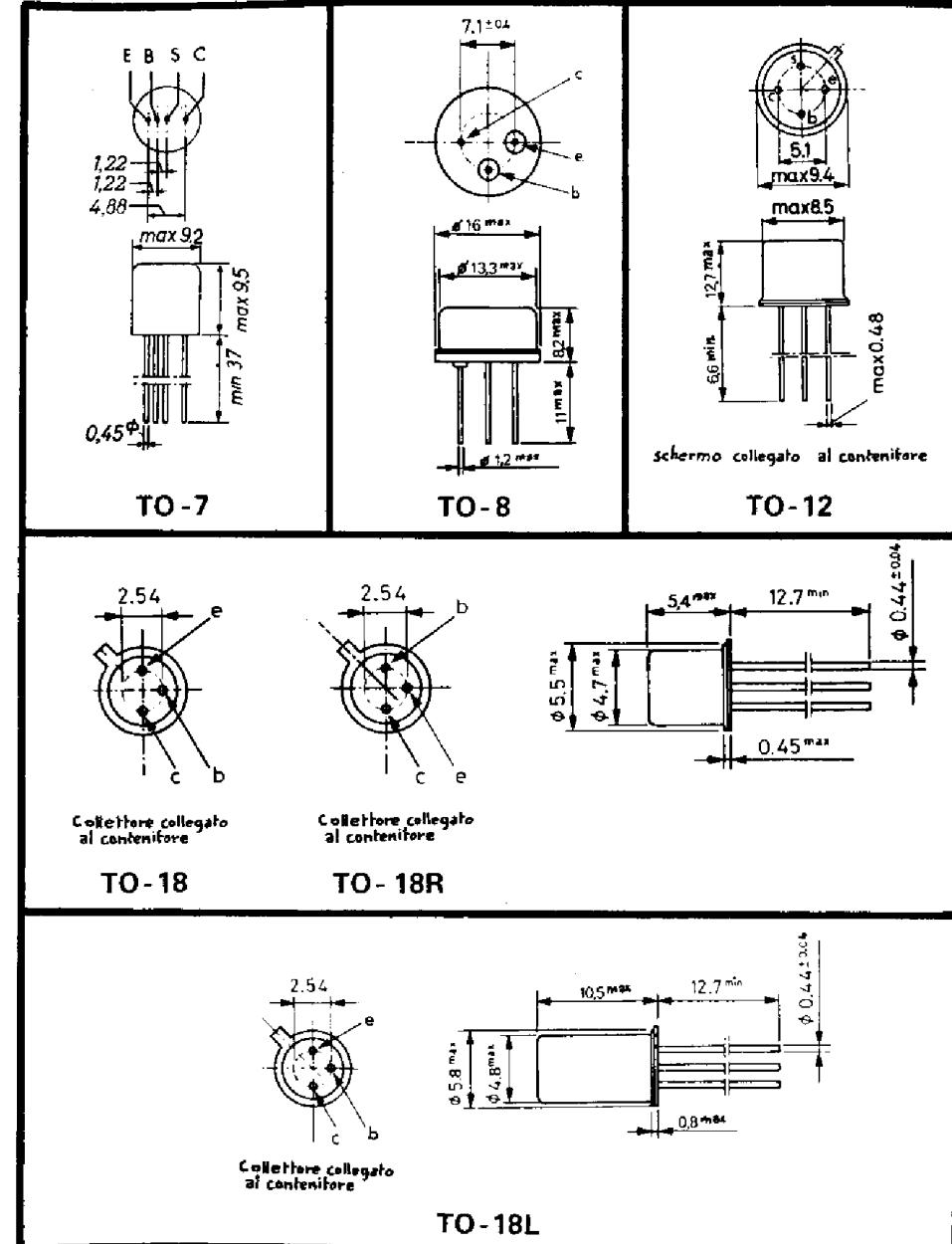
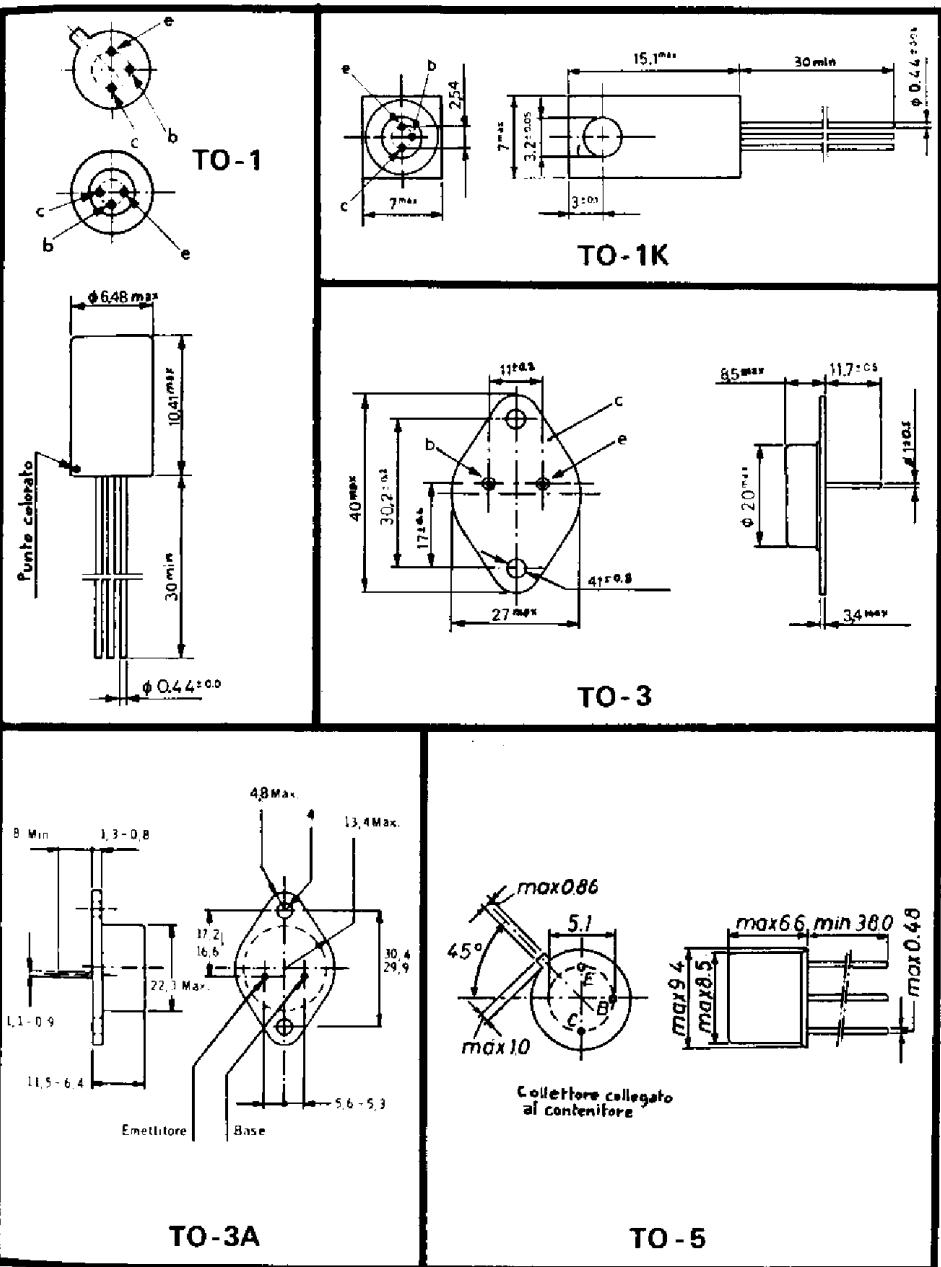
SIGLA	TIPO e CONT.	IMPIEGO	VALORI MASSIMI (T _a = 25 °C)	CARATTERISTICHE (T _a = 25 °C)	a	I _C (mA)	V _{CE} (V)	f (MHz)
SFT351	PNP TO - 1	Preampl. e pilota BF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,15 A R _{thc} : 100 °C/W	P : 0,25 W T _j : 100 °C R _{thc} : 100 °C/W	β : 20 - 45 oro β : 27 arancio β : 37 f _β : 17 kHz f _T : 0,8 MHz	1	6	
				β : 27	1	6		
				β : 37	1	6		
SFT352	PNP TO - 1	Impiego e dati tecnici come SFT351 eccetto:	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W	β : 35 - 65 giallo verde β : 45 β : 55 f _β : 18 kHz f _T : 1,2 MHz	1	6		
				β : 45	1	6		
				β : 55	1	6		
SFT353	PNP TO - 1	Preampl. e pilota BF	V _{CEO} : 20 V V _{CBO} : 32 V I _C : 0,15 A R _{thc} : 100 °C/W	P : 0,25 W T _j : 100 °C β : 55 - 250 blu β : 70 viola β : 90 bianco β : 125 grigio β : 195 f _β : 19 kHz f _T : 2,4 MHz	1	6		
				β : 70	1	6		
				β : 90	1	6		
SFT354	PNP TO - 72L	Oscill. conv. per OM - OC	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W	P : 0,15 W T _j : 100 °C V _{fe} : 38 mS f _T : 80 MHz	β : 150 β : 150 V _{fe} : 38 mS f _T : 80 MHz	1	6	0,5
				V _{fe} : 38 mS f _T : 80 MHz	1	6		
				f _T : 80 MHz	1	6		
SFT357	PNP TO - 72L	Oscill. conv. Per MF	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W	P : 0,15 W T _j : 100 °C V _{fe} : 16 mS f _T : 90 MHz	β : 150 β : 150 V _{fe} : 16 mS f _T : 90 MHz	1	6	100
				V _{fe} : 16 mS f _T : 90 MHz	1	6		
				f _T : 90 MHz	1	6		
SFT358	PNP TO - 72L	Preampl. RF per MF	V _{CEO} : 16 V V _{CBO} : 32 V I _C : 10 mA R _{thc} : 300 °C/W	P : 0,15 W T _j : 100 °C Y _{fb} : 18 mS f _T : 110 MHz	β : 150 β : 150 Y _{fb} : 18 mS f _T : 110 MHz	1	6	100
				Y _{fb} : 18 mS f _T : 110 MHz	1	6		
				f _T : 110 MHz	1	6		
SFT373	NPN TO - 1	Ampl. finale BF compl. SFT323	V _{CEO} : 6 V V _{CBO} : 12 V I _C : 0,3 A R _{thc} : 80 °C/W	P : 0,25 W T _j : 100 °C V _{fe} : 50 - 100 VI β : 75 - 150 VII β : 125 - 250 blu β : 70 viola β : 85 bianco β : 130 f _β : 35 kHz f _T : 3,5 MHz	100	1		
				VI β : 75 - 150	100	1		
				VII β : 125 - 250	100	1		
SFT713	NPN TO - 18	Commutazione	V _{CEO} : 25 V V _{CBO} : 25 V I _C : 0,2 A R _{thc} : 150 °C/W	P : 0,3 W T _j : 175 °C f _T : 300 MHz	h _{FE} : 30 - 90 f _T : 300 MHz	2	4,5	
				T _j : 175 °C	10	5		
				f _T : 300 MHz	10	5		

* * * * *

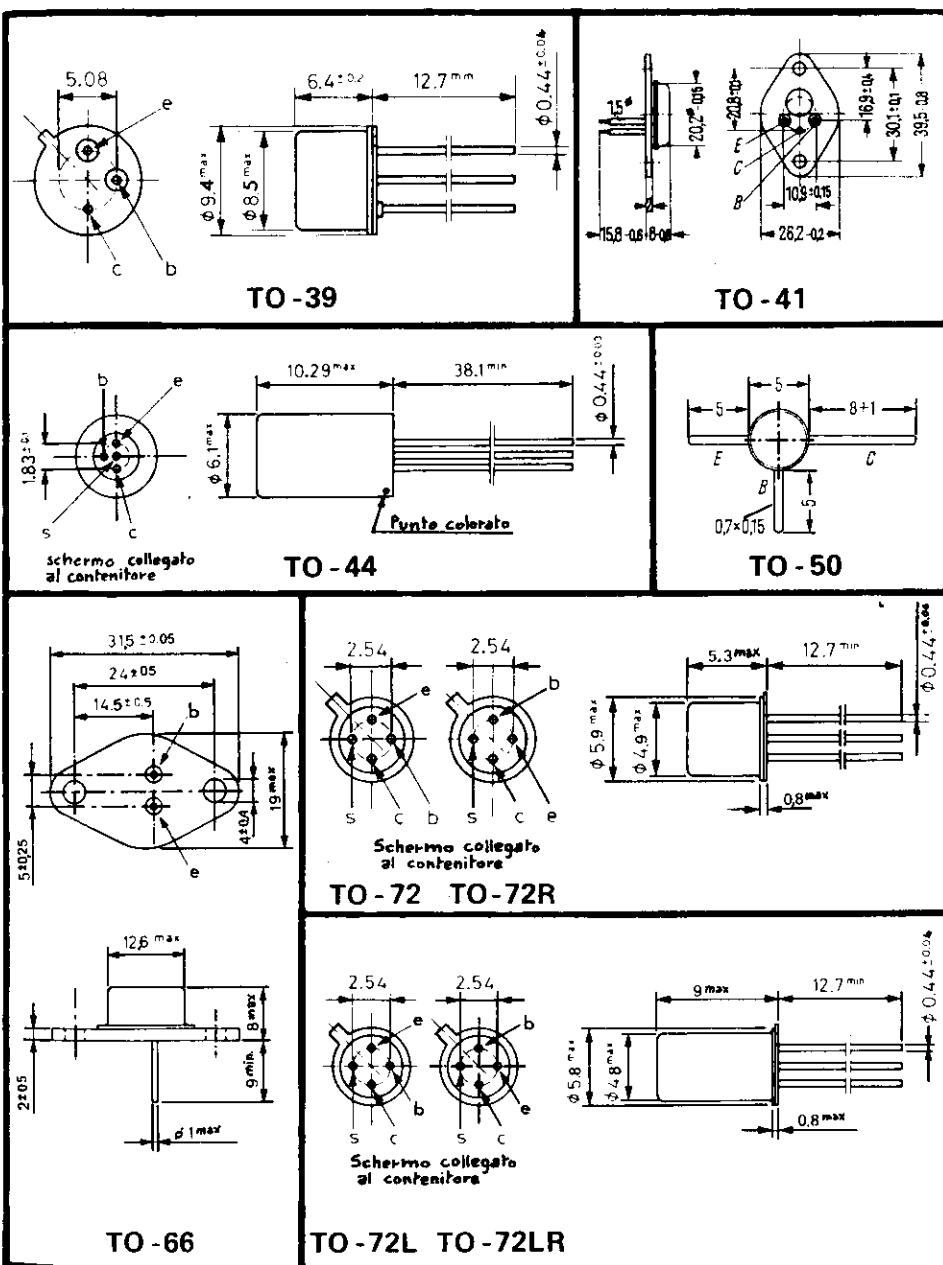
CONTENITORI

(dimensioni in mm)

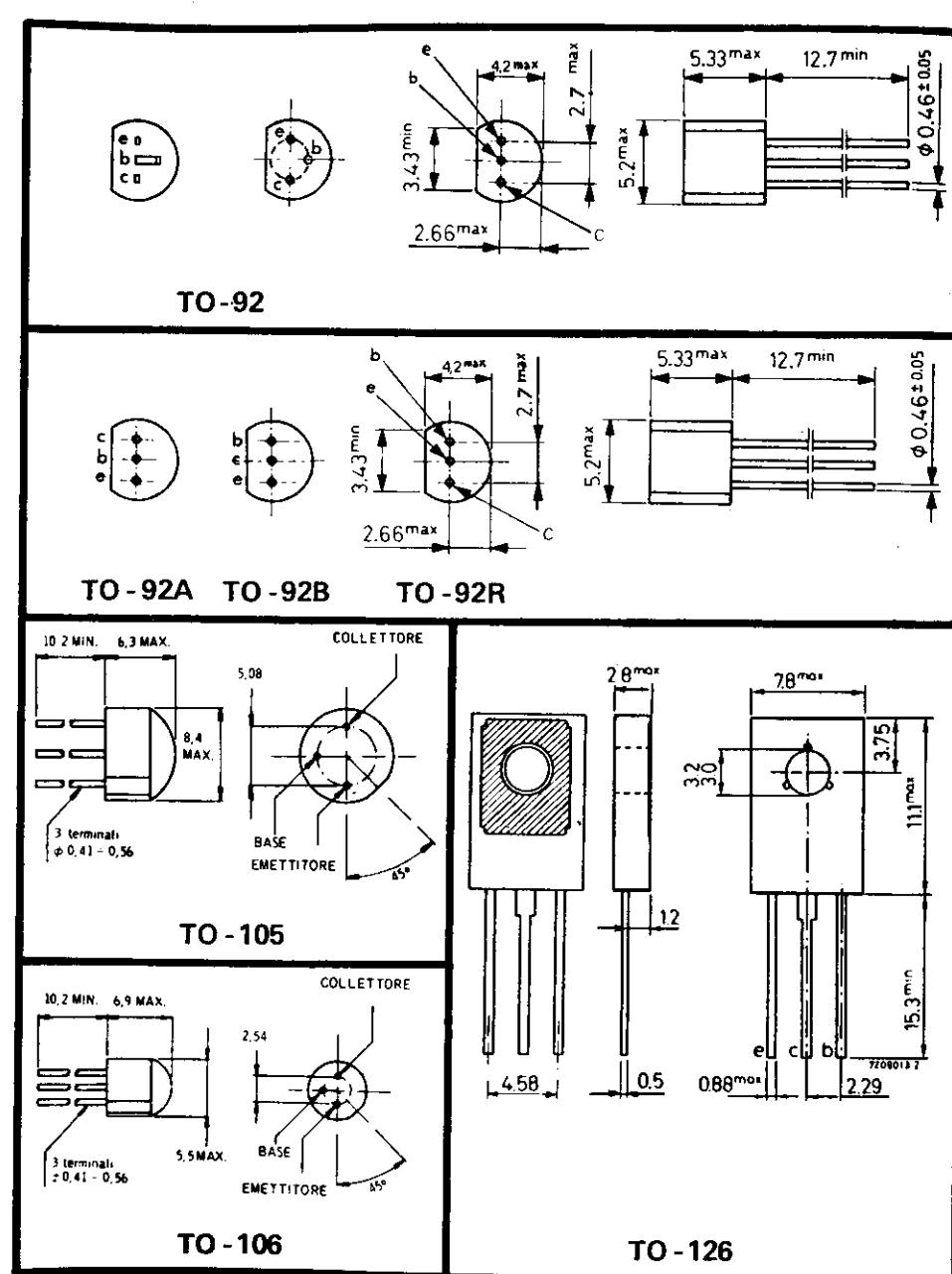




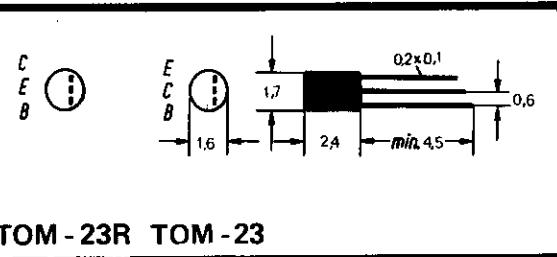
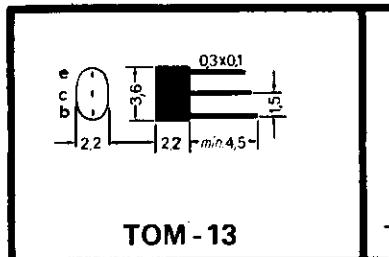
Dati Transistori 2



Dati Transistori 2

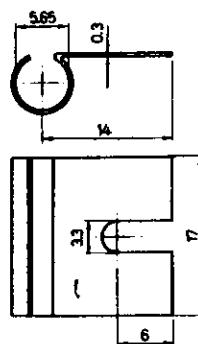


Dati Transistori 2

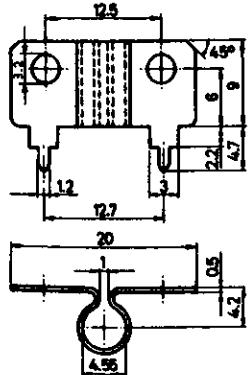


ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

(dimensioni in mm)

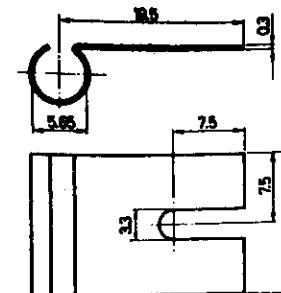
**ALETTA N° 1** (tipo Philips 56227)Resistenza termica $R_{thd} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

Materiale: ottone placcato in nichel

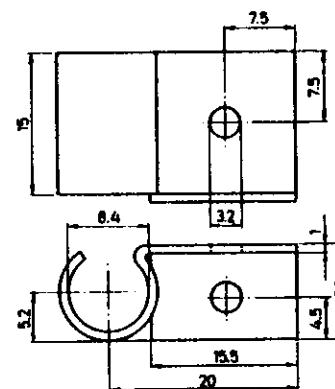
**ALETTA N° 2** (tipo Philips 56263)Resistenza termica $R_{thd} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

Materiale: rame placcato in stagno

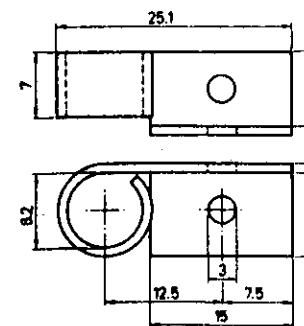
Dati 3

**ALETTA N° 3** (tipo Philips 56200)

Materiale: ottone placcato in nichel

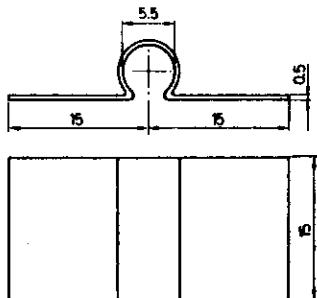
Resistenza termica $R_{thd} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ **ALETTA N° 4** (tipo Philips 56207)

Materiale: alluminio brunito

Resistenza termica $R_{thd} = 60 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ **ALETTA N° 5** (tipo Philips 56265)

Materiale: alluminio brunito

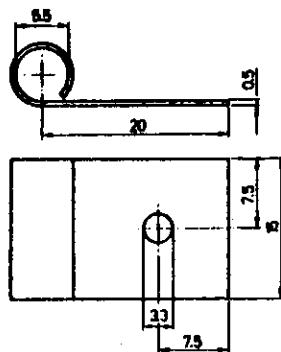
Resistenza termica $R_{thd} = 80 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$



ALETTA N° 6 (tipo Philips 56209)

Materiale: ottone placcato in nichel

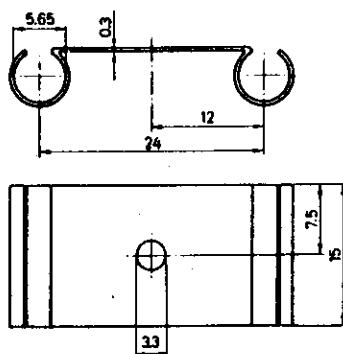
Resistenza termica $R_{thd} \approx 75 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$



ALETTA N° 7 (tipo Philips 56210)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica $R_{thd} = 95 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$



ALETTA N° 8 (tipo Philips 56208)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica $R_{thd} = 102 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$